

SinoMCU 8 位单片机

MC30P6070

用户手册

V1.5



目录

1	产品概要	4
1.1	产品特性	4
1.2	订购信息	5
1.3	引脚排列	5
1.4	端口说明	6
2	电气特性	7
2.1	极限参数	7
2.2	直流电气特性	7
2.3	交流电气特性	9
3	CPU 及存储器	10
3.1	指令集	10
3.2	程序存储器	12
3.3	数据存储器	12
3.4	堆栈	13
3.5	控制寄存器	13
3.6	用户配置字	15
4	系统时钟	17
4.1	内部高频 RC 振荡器	18
4.2	内部低频 RC 振荡器	18
4.3	外部晶体振荡器	18
4.4	系统工作模式	18
4.5	低功耗模式	19
5	复位	20
5.1	复位条件	20
5.2	上电复位	21
5.3	外部复位	21
5.4	低电压复位	21
5.5	看门狗复位	21
6	I/O 端口	22
6.1	通用 I/O 功能	22
6.2	内部上/下拉电阻	22
6.3	端口模式控制	23
7	定时器 TIMER	24
7.1	看门狗定时器 WDT	24
7.2	定时器 T0	25
7.3	定时器 T1	27
8	低电压检测 LVD	30
9	中断	31
9.1	外部中断	31
9.2	定时器中断	31
9.3	键盘中断	31

9.4	中断相关寄存器	32
10	特性曲线	34
10.1	I/O 特性	34
10.2	功耗特性	37
10.3	模拟电路特性	47
10.4	最低工作电压与系统时钟的关系	52
11	封装尺寸	53
11.1	SOP8	53
11.2	DIP8	53
11.3	SOT23-6	54
12	修订记录	55

1 产品概要

1.1 产品特性

- 8 位 CPU 内核
 - ◇ 精简指令集，5 级深度硬件堆栈
 - ◇ CPU 为单时钟，仅在系统主时钟下运行
 - ◇ 系统主时钟下 FCPU 可配置为 2/4 分频
- 程序存储器
 - ◇ 1K×14 位 OTP 型程序存储器（烧录 1 次）
 - ◇ 0.5K×14 位 OTP 型程序存储器（烧录 2 次）
- 数据存储器
 - ◇ 50 字节 SRAM/REG 型通用数据存储器，支持直接寻址、间接寻址等多种寻址方式
- 1 组共 6 个 I/O
 - ◇ P1 (P10~P15)
 - ◇ P13 可配置为单输入或输入/开漏输出口，可复用为外部复位 RST 输入，编程时为高压 VPP 输入
 - ◇ P15/P14 可复用为外部时钟振荡器输入/输出
 - ◇ P10~P15 内置上拉电阻，P10~P12 内置下拉电阻，均可单独使能
 - ◇ P10~P12/P14/P15 可选开漏或推挽输出
 - ◇ P1 所有端口均支持键盘中断唤醒功能，并可单独使能
- 系统时钟源
 - ◇ 内置高频 RC 振荡器（16MHz/8MHz/4MHz/2MHz/1MHz/455KHz），可用作系统主时钟源
 - ◇ 内置低频 RC 振荡器（32KHz），可用作系统主时钟源
 - ◇ 支持外接高频晶体振荡器（455KHz/1MHz~16MHz），可用作系统主时钟源
 - ◇ 支持外接低频晶体振荡器（32768Hz），可用作系统主时钟源、或定时器 RTC 时钟源
- 系统工作模式
 - ◇ 运行模式：CPU 在系统主时钟下运行
 - ◇ 休眠模式：CPU 停止运行，系统主时钟源停止工作
- 内部自振式看门狗计数器（WDT）
 - ◇ 与定时器 T0 共用预分频器
 - ◇ 溢出时间可配置：4.5ms/18ms/72ms/288ms（无预分频）
 - ◇ 工作模式可配置：开启 WDT、关闭 WDT，也可软件控制开启或关闭
- 2 个定时器
 - ◇ 8 位定时器 T0，支持外部 RTC 时钟，可实现外部计数功能，与 WDT 共用预分频器
 - ◇ 8 位定时器 T1，可实现外部计数、BUZ 和 PWM 功能
- 中断
 - ◇ 外部中断（INT），键盘中断（P10~P15），定时器中断（T0~T1）
- 低电压复位 LVR
 - ◇ 1.8V/2.0V/2.3V/2.7V/3.0V/3.6V
- 低电压检测 LVD
 - ◇ 1.8V/2.4V/3.0V/3.3V/3.6V/3.8V/4.0V

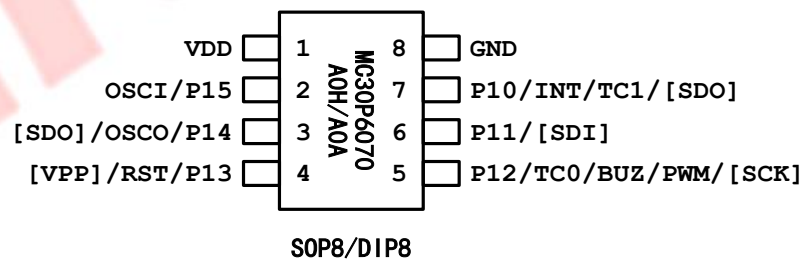
- 工作电压
 - ✧ $V_{LVR30} \sim 5.5V @ F_{cpu} = 0 \sim 8MHz$
 - ✧ $V_{LVR27} \sim 5.5V @ F_{cpu} = 0 \sim 4MHz$
 - ✧ $V_{LVR20} \sim 5.5V @ F_{cpu} = 0 \sim 2MHz$
 - ✧ $V_{LVR18} \sim 5.5V @ F_{cpu} = 0 \sim 32KHz/2$
- 封装形式
 - ✧ SOP8/DIP8/SOT23-6

1.2 订购信息

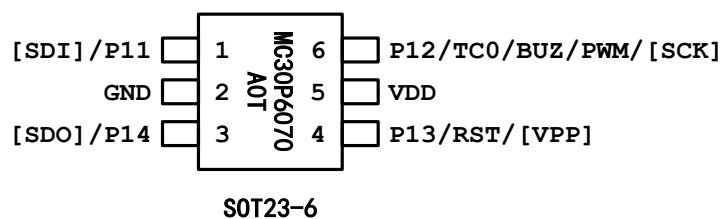
产品名称	封装形式	备注
MC30P6070A0H	SOP8	
MC30P6070A0A	DIP8	
MC30P6070A0T	SOT23-6	
MC30P6070A1T	SOT23-6	

1.3 引脚排列

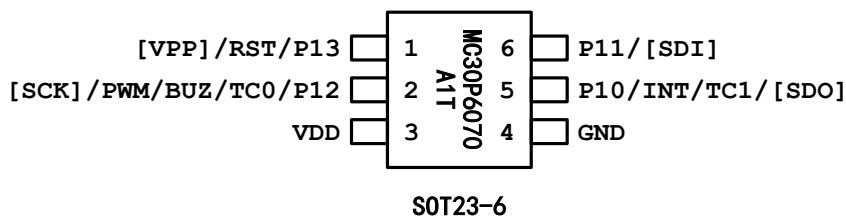
MC30P6070A0H/A0A



MC30P6070A0T



MC30P6070A1T



1.4 端口说明

端口名称	类型	功能说明
VDD	P	电源
GND	P	地
P10~P12	D	GPIO (可选推挽/开漏输出), 内部上/下拉
P14, P15	D	GPIO (可选推挽/开漏输出), 内部上拉
P13	D	GPIO (可配置为单输入或输入/开漏输出口) 内部上拉
INT	DI	外部中断输入
TC0~TC1	DI	定时器 T0~T1 的外部计数输入
PWM/BUZ	DO	定时器 T1 的 PWM/BUZ 输出
OSCI, OSCO	A	外部时钟振荡器输入/输出
RST	DI	外部复位输入
SCK, SDI, SDO	D	编程时钟/数据输入/数据输出接口
VPP	P	编程高压输入

注: P-电源; D-数字输入输出, DI-数字输入, DO-数字输出; A-模拟输入输出, AI-模拟输入, AO-模拟输出。

2 电气特性

2.1 极限参数

参数	符号	值	单位
电源电压	VDD	-0.3~6.0	V
输入电压	Vin	-0.3~VDD+0.3	V
工作温度	Ta	-40~85	°C
储存温度	Tstg	-65~150	°C
流入 VDD 最大电流	IVDDmax	50	mA
流出 GND 最大电流	IGNDmax	50	mA

注：若芯片工作条件超过极限值，则会造成永久性损坏；若芯片长时间工作在极限条件下，则会影响其可靠性。

2.2 直流电气特性

VDD=5V, T=25°C

特性	符号	端口	条件	最小	典型	最大	单位
工作电压	VDD	VDD	Fcpu=0~8MHz	VLVR30		5.5	V
			Fcpu=0~4MHz	VLVR27		5.5	
			Fcpu=0~2MHz	VLVR20		5.5	
			Fcpu=0~1MHz	VLVR20		5.5	
			Fcpu=0~500KHz	VLVR20		5.5	
			Fcpu=0~455KHz/2	VLVR20		5.5	
			Fcpu=0~32KHz/2	VLVR18		5.5	
输入漏电流	Ileak	所有输入脚	VDD=5V	-1		1	uA
输入高电平	Vih1	所有输入脚	VDD=5V, SMT 开启, SMTVS 配置	2.0			V
	Vih2		VDD=3V, SMT 开启, SMTVS 配置	1.6			V
	Vih3		SMT 开启, SMTVS 配置	0.8VDD			V
			VDD=5V, SMT 关闭	2.0			V
			VDD=3V, SMT 关闭	1.5			V
输入低电平	Vil1	所有输入脚	VDD=5V, SMT 开启, SMTVS 配置			0.8	V
	Vil2		VDD=3V, SMT 开启, SMTVS 配置			0.6	V
	Vil3		SMT 开启, SMTVS 配置			0.2VDD	V
			VDD=5V, SMT 关闭			1.0	V
			VDD=3V, SMT 关闭			0.7	V
输出拉电流	Ioh	推挽输出脚	VDD=5V, Voh=4.3V	6			mA
输出灌电流	Iol	所有输出脚	VDD=5V, Vol=0.7V	10			mA

上拉电阻	Rpu1	P1	VDD=5V, Vin=0, RUSEL 配置	40	80	160	KΩ
			VDD=3V, Vin=0, RUSEL 配置	90	190	380	KΩ
	Rpu2	P1(除 P13)	VDD=5V, Vin=0, RUSEL 配置	10	20	40	KΩ
下拉电阻	Rpd	P10-P12	Vin=VDD=5V	60	125	250	KΩ
			Vin=VDD=3V	225	450	900	KΩ
运行模式功耗	Irun	VDD	Fcpu=8MHz@HIRC(16M)		2.0		mA
			Fcpu=8MHz@HEXT(16M)		2.5		mA
			Fcpu=4MHz@HIRC(8M)		1.0		mA
			Fcpu=4MHz@HEXT(8M)		1.5		mA
			Fcpu=2MHz@HIRC(4M)		0.55		mA
			Fcpu=2MHz@HEXT(4M)		1.2		mA
			Fcpu=1MHz@HIRC(2M)		300		uA
			Fcpu=500KHz@HIRC(1M)		250		uA
			Fcpu=227.5KHz@HIRC(455K)		220		uA
			Fcpu=227.5KHz@HEXT(455K)		350		uA
			VDD=5V, Fcpu=FLIRC/2, LVR 开		9.2		uA
			VDD=3V, Fcpu=FLIRC/2, LVR 开		7.2		uA
			VDD=5V, Fcpu=FLEXT/2, LVR 开		22.2		uA
			VDD=3V, Fcpu=FLEXT/2, LVR 开		9.2		uA
休眠模式功耗	Istop	VDD	WDT 关, LVR 关		0.1	1	uA
			WDT 关, LVR 开		7	30	uA
			VDD=5V, WDT 开, LVR 关		0.9	3	uA
			VDD=3V, WDT 开, LVR 关		0.3	2	uA
			VDD=5V, LEXT 开, LVR 关		10	20	uA
			VDD=3V, LEXT 开, LVR 关		3.3	7	uA
低压检测电压	VLVD	VDD		-5%		+5%	V
LVD 响应时间	TLVD				0.3	2	ms
低压复位电压	VLVR18	VDD		-5%	1.8	+5%	V
	VLVR20			-5%	2.0	+5%	
	VLVR27			-5%	2.7	+5%	
	VLVR30			-5%	3.0	+5%	
	其他			-5%		+5%	
LVD/LVR 回滞电压		VDD			6%	12%	

注：条件项中，未注明模块默认关闭，无关端口状态为输出无负载，输入或开漏输出高则端口电压为 VDD/GND。

2.3 交流电气特性

特性	符号	条件	最小	典型	最大	单位
HIRC 振荡频率	F _{HIRC}	VDD=5V, T=25°C	-3%	455K-	+3%	Hz
		VDD=2.0V~5.5V, T=-40°C~85°C	-5%	16M	+5%	
LIRC 振荡频率	F _{LIRC}	VDD=5V, T=25°C	-50%	32	+50%	KHz
16M 晶振起振电压		T=25°C	2.0			V
8M 晶振起振电压		T=25°C	1.8			V
4M 晶振起振电压		T=25°C	1.8			V
455K 晶振起振电压		T=25°C	1.8			V
32768 晶振起振电压		T=25°C	1.6			V
32768 晶振起振时间		VDD=5V, T=25°C		1		s

3 CPU 及存储器

3.1 指令集

芯片的指令集为精简指令集。除程序跳转类指令，其余指令均为单周期指令，即执行时间为 1 个指令周期；所有指令均为单字指令，即指令码只占用 1 个程序存储器地址空间。

指令汇总表

助记符	说明	操作	周期	长度	标志
ADDAR R	R 和 ACC 相加，结果存入 ACC	$R + ACC \rightarrow ACC$	1	1	C,DC,Z
ADDRA R	R 和 ACC 相加，结果存入 R	$R + ACC \rightarrow R$	1	1	C,DC,Z
ADCAR R	R 和 ACC 相加（带 C 标志），结果存入 ACC	$R + ACC + C \rightarrow ACC$	1	1	C,DC,Z
ADCRA R	R 和 ACC 相加（带 C 标志），结果存入 R	$R + ACC + C \rightarrow R$	1	1	C,DC,Z
RSUBAR R	R 和 ACC 相减，结果存入 ACC	$R - ACC \rightarrow ACC$	1	1	C,DC,Z
RSUBRA R	R 和 ACC 相减，结果存入 R	$R - ACC \rightarrow R$	1	1	C,DC,Z
RSBCAR R	R 和 ACC 相减（带 C 标志），结果存入 ACC	$R - ACC - C \rightarrow ACC$	1	1	C,DC,Z
RSBCRA R	R 和 ACC 相减（带 C 标志），结果存入 R	$R - ACC - C \rightarrow R$	1	1	C,DC,Z
ANDAR R	R 和 ACC 与操作，结果存入 ACC	$R \text{ and } ACC \rightarrow ACC$	1	1	Z
ANDRA R	R 和 ACC 与操作，结果存入 R	$R \text{ and } ACC \rightarrow R$	1	1	Z
ORAR R	R 和 ACC 或操作，结果存入 ACC	$R \text{ or } ACC \rightarrow ACC$	1	1	Z
ORRA R	R 和 ACC 或操作，结果存入 R	$R \text{ or } ACC \rightarrow R$	1	1	Z
XORAR R	R 和 ACC 异或操作，结果存入 ACC	$R \text{ xor } ACC \rightarrow ACC$	1	1	Z
XORRA R	R 和 ACC 异或操作，结果存入 R	$R \text{ xor } ACC \rightarrow R$	1	1	Z
COMAR R	对 R 取反，结果存入 ACC	$R \text{ 取反} \rightarrow ACC$	1	1	Z
COMR R	对 R 取反，结果存入 R	$R \text{ 取反} \rightarrow R$	1	1	Z
RLAR R	R 循环左移（带 C 标志），结果存入 ACC	$R[7] \rightarrow C$ $R[6:0] \rightarrow ACC[7:1]$ $C \rightarrow ACC[0]$	1	1	C
RLR R	R 循环左移（带 C 标志），结果存入 R	$R[7] \rightarrow C$ $R[6:0] \rightarrow R[7:1]$ $C \rightarrow R[0]$	1	1	C
RRAR R	R 循环右移（带 C 标志），结果存入 ACC	$R[0] \rightarrow C$ $R[7:1] \rightarrow ACC[6:0]$ $C \rightarrow ACC[7]$	1	1	C
RRR R	R 循环右移（带 C 标志），结果存入 R	$R[0] \rightarrow C$ $R[7:1] \rightarrow R[6:0]$ $C \rightarrow R[7]$	1	1	C
SWAPAR R	交换 R 的高低半字节，结果存入 ACC	$R[7:4] \rightarrow ACC[3:0]$ $R[3:0] \rightarrow ACC[7:4]$	1	1	-
SWAPR R	交换 R 的高低半字节，结果存入 R	$R[7:4] \rightarrow R[3:0]$ $R[3:0] \rightarrow R[7:4]$	1	1	-

MOVRA R	将 ACC 存入 R	ACC→R	1	1	-
MOVAR R	将 R 存入 ACC	R→ACC	1	1	Z
MOVR R	将 R 存入 R	R→R	1	1	Z
CLRA	清零 ACC	0→ACC	1	1	Z
CLRR R	清零 R	0→R	1	1	Z
INCR R	R 自加 1	R+1→R	1	1	Z
INCAR R	R 加 1, 结果存入 ACC	R+1→ACC	1	1	Z
DECR R	R 自减 1	R-1→R	1	1	Z
DECAR R	R 减 1, 结果存入 ACC	R-1→ACC	1	1	Z
JZR R	R 自加 1; 结果为 0 则跳过下一条指令	R+1→R; 结果为 0 则 PC+2→PC	1/2	1	-
JZAR R	R 加 1, 结果存入 ACC; 结果为 0 则跳过下一条指令	R+1→ACC; 结果为 0 则 PC+2→PC	1/2	1	-
DJZR R	R 自减 1; 结果为 0 则跳过下一条指令	R-1→R; 结果为 0 则 PC+2→PC	1/2	1	-
DJZAR R	R 减 1, 结果存入 ACC; 结果为 0 则跳过下一条指令	R-1→ACC; 结果为 0 则 PC+2→PC	1/2	1	-
BCLR R, b	将 R 的第 b 位清 0	0→R[b]	1	1	-
BSET R, b	将 R 的第 b 位置 1	1→R[b]	1	1	-
JBCLR R, b	若 R 的第 b 位为 0, 则跳过下一条指令	若 R[b]=0, 则 PC+2→PC	1/2	1	-
JBSET R, b	若 R 的第 b 位为 1, 则跳过下一条指令	若 R[b]=1, 则 PC+2→PC	1/2	1	-
ADDAI K	K 和 ACC 相加, 结果存入 ACC	K+ACC→ACC	1	1	C,DC,Z
ISUBAI K	K 和 ACC 相减, 结果存入 ACC	K-ACC→ACC	1	1	C,DC,Z
ANDAI K	K 和 ACC 与操作, 结果存入 ACC	K and ACC→ACC	1	1	Z
ORAI K	K 和 ACC 或操作, 结果存入 ACC	K or ACC→ACC	1	1	Z
XORAI K	K 和 ACC 异或操作, 结果存入 ACC	K xor ACC→ACC	1	1	Z
MOVAI K	将 K 存入 ACC	K→ACC	1	1	-
CALL K	子程序调用	PC+1→TOS K→PC[10:0]	2	1	-
GOTO K	无条件跳转	K→PC[10:0]	2	1	-
RETURN	从子程序返回	TOS→PC	2	1	-
RETAI K	从子程序返回, 并将 K 存入 ACC	TOS→PC K→ACC	2	1	-
RETIE	从中断返回	TOS→PC 1→GIE	2	1	-
NOP	空操作	空操作	1	1	-
DAA	BCD 码加法后, 将 ACC 的值调整为 BCD 码	ACC(HEX 码)→ACC(BCD 码)	1	1	C
DSA	BCD 码减法后, 将 ACC 的值调整为 BCD 码	ACC(HEX 码)→ACC(BCD 码)	1	1	-
CLRWDT	清零看门狗定时器	0→WDT	1	1	TO,PD
STOP	进入低功耗模式	0→WDT; CPU 暂停	1	1	TO,PD

注:

- 1、ACC-算术逻辑单元累加器, R-数据存储器, K-立即数;
- 2、对于条件跳转类指令, 若跳转条件成立, 则指令需 2 个周期, 否则只需 1 个周期;

3.2 程序存储器

芯片的程序存储器为 OTP 型存储器，可通过配置字 PAGE 选择存储器的地址空间范围。

1K×14 位的地址空间范围为 0000H~03FFH，仅能烧录 1 次，地址分配如下图所示：

复位起始地址 (0000H)
通用程序区 (0001H - 0007H)
中断入口地址 (0008H)
通用程序区 (0009H - 03FFH)

0.5K×14 位的地址空间范围为 0000H~01FFH，可以烧录 2 次，地址分配如下图所示：

复位起始地址 (0000H)
通用程序区 (0001H - 0007H)
中断入口地址 (0008H)
通用程序区 (0009H - 01FFH)

3.3 数据存储器

数据存储器包括通用数据存储器 GPR 和特殊功能寄存器 SFR，具体地址分配参照下表。GPR/SFR0 可直接寻址或通过 INDF 间接寻址，SFR1 仅支持直接寻址。

数据存储器区地址映射表

地址	类型	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
00H-07H	SFR0	INDF	T0CNT	PCL	STATUS	FSR	GPR0	P1	GPR1
08H-0FH		MCR	KBIM	PCLATH	PDCON	ODCON	PUCON	INTECON	INTFLAG
10H-3FH	GPR	通用数据存储器区							
40H-47H	SFR1		T0CR					DDR1	
48H-4FH					TM0CR	T1CR	T1CNT	T1LOAD	T1DATA
50H-7FH	保留								

注：

- 1、上表中灰色部分地址为系统保留区，读出数据不确定，写入操作可能会影响芯片正常工作；
- 2、SFR 中的 GPR0 (05H)、GPR1 (07H) 可用作通用数据存储器 GPR；

数据存储器寻址模式地址组成

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	寻址模式
/	/	/	/	/	/	/	/	/	来自指令的 7 位地址							直接寻址模式
/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	FSR						间接寻址模式

直接寻址模式，是以指令的低 7 位为数据存储器地址，通过指令访问，寻址范围为 00H~7FH。例：
通过直接寻址模式将数据 55H 写入数据存储器 10H 地址

```
MOVAI    55H
MOVRA    10H           ; 将数据 55H 写入数据存储器 10H 地址
```

间接寻址模式，是以 FSR 为数据存储器地址指针，通过 INDF 访问，寻址范围为 00H~3FH。例：
通过间接寻址模式将数据 55H 写入数据存储器 10H 地址

```
MOVAI    10H
MOVRA    FSR
MOVAI    55H
MOVRA    INDF          ; 将数据 55H 写入 FSR 指向的数据存储器中
```

3.4 堆栈

5 级堆栈深度，当程序响应中断或执行子程序调用指令时 CPU 会将 PC 自动压栈保存；当执行中断返回指令或子程序返回指令时，栈顶数据自动出栈载入 PC。

3.5 控制寄存器

数据指针寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
FSR	-	-	FSR5	FSR4	FSR3	FSR2	FSR1	FSR0
R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	1	1	0	0	0	0	0	0

BIT[5:0] **FSR[5:0]** – 数据指针寄存器
FSR：间接寻址模式的指针，仅低 6 位有效。

间接寻址寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
INDF	INDF7	INDF6	INDF5	INDF4	INDF3	INDF2	INDF1	INDF0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	X	X	X	X	X	X	X	X

BIT[7:0] **INDF[7:0]** – 间接寻址寄存器
INDF：INDF 不是物理寄存器，对 INDF 寻址实际是对 FSR 指向的数据存储器地址进行访问，从而实现间接寻址功能。

程序指针计数器低字节

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PCL	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] **PC[7:0]** – 程序指针计数器低 8 位

程序指针计数器高位缓存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PCLATH	-	-	-	-	-	-	PCH1	PCH0
R/W	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
初始值	-	-	-	-	-	-	0	0

BIT[1:0] **PCH[1:0]** – 程序指针计数器高 2 位缓存器

程序指针计数器（PC）有以下几种操作模式：

- ✧ 顺序运行指令：PC = PC + 1；
- ✧ 分支指令 GOTO/CALL：PC = 指令码低 10 位；
- ✧ 返回指令 RETIE/RETURN/RETAI：PC = 堆栈栈顶（TOS）；

对 PCL 操作指令（兼容义隆模式）：

- ✧ 对 PCL 操作的加法指令：PC = (PC[9:0]+ALU[7:0])；
- ✧ 对 PCL 操作的其他指令：PC = {PC[9:8]:ALU[7:0](ALU 运算结果)}；

对 PCL 操作指令（兼容菲林模式）：

- ✧ 对 PCL 操作指令：PC = {PCLATH[1:0]:ALU[7:0](ALU 运算结果)}；

CPU 状态寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STATUS	RST	-	-	TO	PD	Z	DC	C
R/W	R/W	-	-	R	R	R/W	R/W	R/W
初始值	0	-	-	1	1	X	X	X

BIT[7] **RST** – 唤醒源标志位

- 0：芯片通过其他唤醒源唤醒；
- 1：芯片通过外部中断或键盘中断唤醒；

BIT[4] **TO** – 看门狗溢出标志位

- 0：发生 WDT 溢出；
- 1：上电复位，或执行 CLRWDT/STOP 指令；

BIT[3] **PD** – 进入低功耗模式标志位

- 0：执行 STOP 指令；
- 1：上电复位，或执行 CLRWDT 指令；

LVRVS	LVR 复位电压选择：(LVR 电压应满足由 F _{CPU} 决定的工作电压特性) 1.8V; 2.0V; 2.3V; 2.7V; 3.0V; 3.6V;
LVRMD	LVR 模式设置： LVR 始终开启； LVR 在运行模式下开启，在低功耗模式下关闭；
WDTM	WDT 模式设置： WDT 始终关闭； WDT 始终开启；
WDTT	上电延时及 WDT 溢出时间（无预分频）选择：(时间均为典型值) 上电延时=2.2ms，WDT 溢出时间=4.5ms； 上电延时=9ms，WDT 溢出时间=18ms； 上电延时=36ms，WDT 溢出时间=72ms； 上电延时=144ms，WDT 溢出时间=288ms；
SMTEN	端口输入施密特设置： 输入 SMT 功能关闭； 输入 SMT 功能开启；
SMTVS	端口施密特阈值选择： 2.0V/0.8V； 0.8VDD/0.2VDD；
RUSEL	端口上拉电阻选择（除 P13）： 80KΩ； 20KΩ；
P13PMS	P13 端口模式选择： P13 为单输入口； P13 为输入/开漏输出口；
RDPORT	输出口读操作设置： 输出口读操作将读取寄存器内容； 输出口读操作将读取端口电平状态；
T1LDS	T1 自动重载功能设置： 写 T1LOAD 溢出后重载； 写 T1LOAD 立即重载；
MCUSEL	芯片模式选择： 兼容义隆模式； 兼容菲林模式；
ENCRC	程序代码加密设置： 程序代码加密； 程序代码不加密；

芯片模式说明

模块/功能	兼容义隆模式	兼容菲林模式
复位地址	0000H	存储空间最后地址
P1 键盘中断允许位	有键盘中断功能，无允许位	有键盘中断功能且有允许位
外部中断触发沿	下降沿	上升沿或下降沿
指令操作 GIE	只能用 BSET/BCLR 指令	无指令限制
PC 高位缓存器 PCLATH	无	有
指令操作 PCL	ADDRA 指令：PC={PC[9:0]+ALU[7:0]}; 其它指令：PC={PC[9:8]:ALU[7:0]}; (ALU 运算结果)	PC={PCLATH[1:0]:ALU[7:0]}; (ALU 运算结果)

4 系统时钟

芯片为双时钟系统（可配置为单时钟模式），内部电路均在系统主时钟 Fosc 或系统低频时钟 FLOSC 下工作，部分模块的时钟还可在 Fosc 和 FLOSC 之间切换。

系统主时钟 Fosc 可通过配置字 OSCM 选择以下时钟：

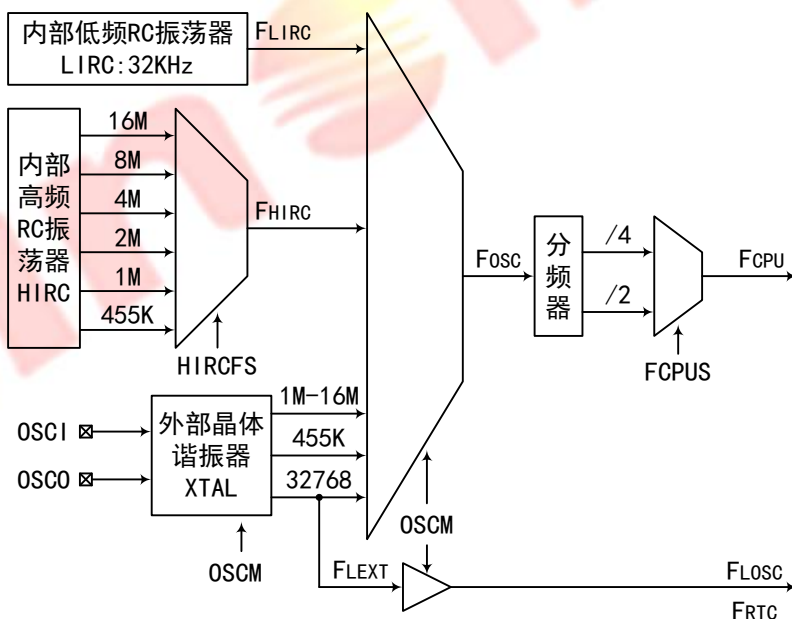
- ✧ 内部高频 RC 振荡器 HIRC（16MHz/8MHz/4MHz/2MHz/1MHz/455KHz）时钟 FHIRC；
- ✧ 内部低频 RC 振荡器 LIRC（32KHz）时钟 FLIRC；
- ✧ 外部高频晶体振荡器 HEXT（455KHz/1MHz~16MHz）时钟 FHEXT；
- ✧ 外部低频晶体振荡器 LEXT（32768Hz）时钟 FLEXT；

系统低频时钟 FLOSC 在通过配置字 OSCM 配置为双时钟模式时固定为外部低频晶体振荡器 LEXT（32768Hz）时钟 FLEXT，同时也用作 RTC 时钟。

CPU 为单时钟，时钟源固定为系统主时钟 Fosc，CPU 的时钟频率 Fcpu 通过配置字 FCPUS 选择。

WDT（看门狗）电路的时钟源固定为内部低频 RC 振荡器。

系统时钟示意图



4.1 内部高频 RC 振荡器

芯片内置 1 个振荡频率可通过配置字 HIRCFS 选择（16MHz/8MHz/4MHz/2MHz/1MHz/455KHz）的高精度 HIRC 振荡器，可用作系统主时钟源。

4.2 内部低频 RC 振荡器

芯片内置 1 个振荡频率典型值为 32KHz 的 LIRC 振荡器，可用作系统主时钟源，也用于系统上电延时控制、WDT 定时器等电路。

4.3 外部晶体振荡器

芯片支持外接高频 455KHz/1MHz~16MHz、或低频 32768Hz 的晶体振荡器作为系统主时钟源。还可在系统时钟配置为双时钟模式时，选择外接 32768Hz 晶体振荡器作为系统低频时钟源和 RTC 时钟源。

外接晶振的实际应用中，晶振两端的对地电容 CG/CD 是必需的。用户应使晶振离 OSCI/OSCO 引脚的距离尽可能短，这样有助于振荡器的起振和振荡的稳定性。

下表是典型频率晶振选用电容 CG/CD 的推荐值和相应最低起振电压参考值。

晶振频率 (Hz)	电容 CG/CD (pF)	最低起振电压 (V)
16M	10	2.0
8M	10/20	1.8
4M	10/20	1.8
455K	100/220	1.8
32768	10	1.6

注：因晶振品牌繁多且工艺差异较大，故上表中的参数仅供参考，具体应用请以晶振的实测结果为准。

4.4 系统工作模式

芯片支持运行模式和休眠模式 2 种系统工作模式。

工作模式	切入条件	系统状态
运行模式	系统复位	CPU 运行，主时钟源工作
	休眠模式下，CPU 唤醒	
休眠模式	运行模式下，执行 STOP 指令	CPU 暂停，主时钟源停止

注：

- 1、LEXT 为系统低频时钟源时不受工作模式影响，若系统时钟配置为双时钟模式则 LEXT 将一直工作；
- 2、系统时钟配置为 LIRC 单时钟模式时，运行模式下 LIRC 一直工作，休眠模式下 LIRC 是否工作由 WDT 决定；而系统时钟配置为其他单时钟模式时，无论运行模式还是休眠模式，LIRC 是否工作均由 WDT 决定；

4.5 低功耗模式

芯片的低功耗模式即为休眠模式。

执行 STOP 指令可使系统进入低功耗模式，同时对系统会产生以下影响：

- ✧ CPU 停止运行；
- ✧ 根据不同模式停止相应时钟源的振荡；
- ✧ RAM 内容保持不变；
- ✧ 所有的输入输出端口保持原态不变；
- ✧ 定时器若其时钟源未停止，则可以保持继续工作；

以下情况可使系统退出低功耗模式：

- ✧ 上电复位；
- ✧ 外部复位（若有外部复位功能）；
- ✧ 有 WDT 溢出（若低功耗模式下 WDT 保持继续工作）；
- ✧ 有外部中断请求发生（若有外部中断功能）；
- ✧ 定时器溢出中断发生（若低功耗模式下定时器保持继续工作）；
- ✧ 有键盘中断请求发生（若有键盘中断功能）；

注：

- 1、低功耗模式下触发中断请求时，若对应的中断使能位关闭，则不会退出低功耗模式；若对应的中断使能位开启而中断总使能位关闭，则仅唤醒 CPU 执行下一条指令；若对应的中断使能位和中断总使能位均开启，则唤醒 CPU 后执行中断服务程序；
- 2、未使用或未封出的引脚，应将其对应的 I/O 端口设置为输出、输入上拉或输入下拉等稳定态，以免因引脚浮空而产生漏电流或非预期的中断唤醒；

5 复位

5.1 复位条件

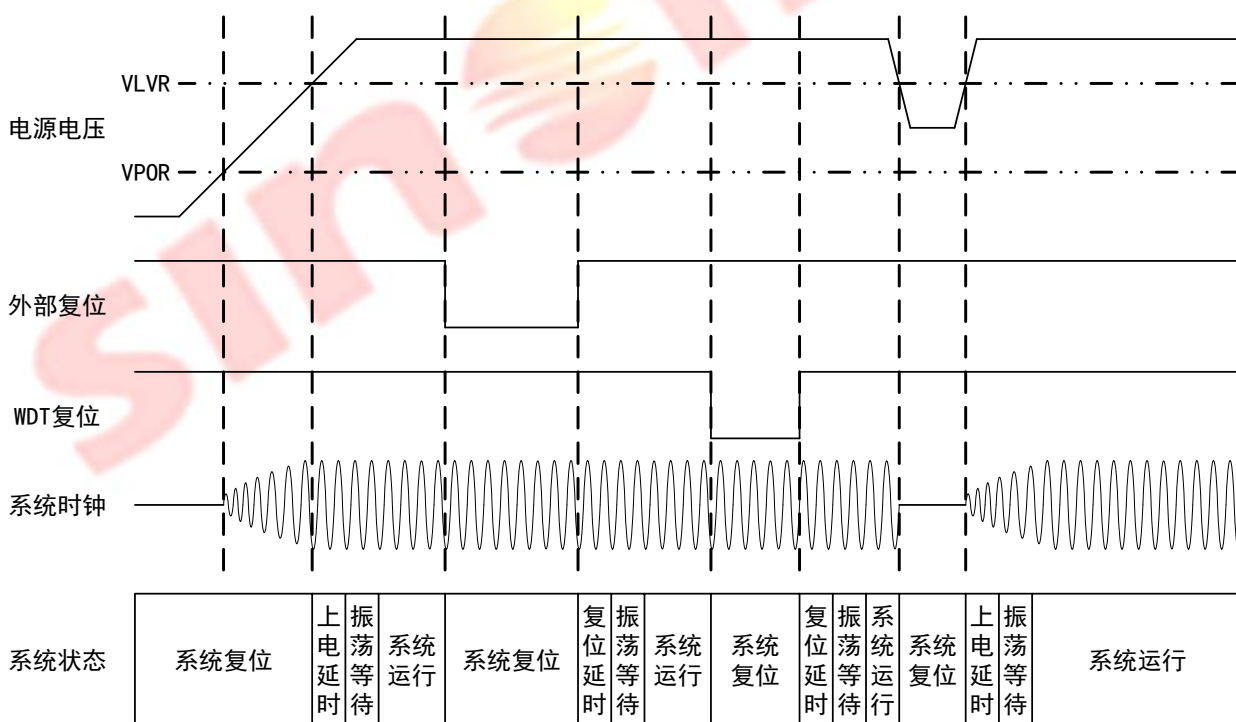
芯片共有如下几种复位方式：

- ✧ 上电复位 POR；
- ✧ 外部复位；
- ✧ 低电压复位 LVR；
- ✧ WDT 看门狗复位；

任何一种复位发生后，系统进入复位状态，执行初始化操作并重置 SFR 为复位初始值；复位条件解除后，系统退出复位状态，CPU 开始重新从程序存储器 0000H 地址处执行指令。

上电复位 POR 和低电压复位 LVR 会关闭系统主时钟振荡器，复位解除后才重新打开振荡器，因为振荡器起振和稳定需要一定的时间，所以系统会保持一定时间的上电延时和振荡等待后才开始工作；而外部复位和 WDT 复位不会关闭主时钟振荡器，复位解除时系统会在较短的复位延时和振荡等待后即开始工作。

下图是复位产生和系统工作状态之间时序关系的示意图：



注：若应用系统在上电或掉电回升时芯片的 VDD 电压上升较慢，则应通过配置字选择较长的上电延时时间，或在复位后进行软件延时，以确保芯片开始工作时 VDD 已稳定在 F_{CPU} 对应的工作电压范围内。

5.2 上电复位

芯片的上电复位电路可以适应快速、慢速上电的情况，且当芯片上电过程中出现电源电压抖动时均能保证系统可靠的复位。

上电复位过程可以概括为以下几个步骤：

- (1) 检测系统工作电压，等待电压高于上电复位电压 V_{POR} 并保持稳定；
- (2) 若有 LVR 功能，则需等待电压高于 V_{LVR} 并保持稳定；
- (3) 若有外部复位功能，则需等待复位引脚电压高于 V_{ih} ；
- (4) 初始化所有寄存器；
- (5) 开启主时钟振荡器，并等待一段时间以待振荡器稳定；
- (6) 上电结束，系统开始执行指令。

5.3 外部复位

芯片的外部复位功能可通过配置字 **RSTEN** 开启，引脚设为外部复位脚即开启外部复位功能，端口的内部上拉电阻自动使能。外部复位输入端口 **RST** 为施密特结构，低电平有效。当端口输入为高电平时，系统正常运行；输入为低电平时，系统复位。

5.4 低电压复位

芯片的低电压复位电压可通过配置字 **LVRVS** 选择。电压检测电路有一定的回滞特性，回滞电压为 6% 左右（典型值），当电源电压下降至 LVR 电压时 LVR 复位有效，反之则电源电压需上升至 LVR 电压 +6% 后 LVR 复位才解除。

5.5 看门狗复位

看门狗（WDT）复位是一种对程序正常运行的保护机制。正常情况下，用户程序需定时对 WDT 定时器进行清零操作，以保证 WDT 不溢出。若出现异常情况，程序未按时对 WDT 定时器清零，则芯片会因 WDT 溢出而产生看门狗复位，系统重新初始化，返回受控状态。

注：低功耗模式下 CPU 暂停工作，若此时有 WDT 溢出，则仅唤醒 CPU 而不产生复位。

6 I/O 端口

6.1 通用 I/O 功能

芯片的输入/输出端口为一组 6 位端口 P1。所有 I/O 端口均支持施密特输入，除 P13 外的 I/O 端口均支持推挽输出。除用作通用数字 I/O 端口外，部分端口还具有外部中断输入、PWM 输出等复用功能。

端口数据寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P1	-	-	P15D	P14D	P13D	P12D	P11D	P10D
R/W	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	-	-	X	X	X	X	X	X

BIT[5:0] P1nD – P1n 端口数据位 (n=5-0)

端口方向寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DDR1	-	-	DDR15	DDR14	DDR13	DDR12	DDR11	DDR10
R/W	-	-	W	W	W	W	W	W
初始值	-	-	1	1	1	1	1	1

BIT[5:0] DDR1n – P1n 端口方向控制位 (n=5-0)

- 0: 端口作为输出口，读端口操作可配置为读取端口数据寄存器值或端口输入电平状态；
- 1: 端口作为输入口，读端口操作将读取端口的输入电平状态；

注：端口 P13 配置为单输入口时，DDR13 位无效；配置为外部复位输入时，读端口操作的数据不确定。

6.2 内部上/下拉电阻

所有端口均有内部上拉或下拉电阻，且均有单独的寄存器位控制其上/下拉电阻在端口处于输入状态时是否有效。端口处于输出状态时，上/下拉电阻及其控制位无效。

上拉电阻控制寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PUCON	-	-	P15PU	P14PU	P13PU	P12PU	P11PU	P10PU
R/W	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	-	-	1	1	1	1	1	1

BIT[5:0] P1nPU – P1n 端口上拉电阻控制位 (n=5-0)

- 0: 端口内部上拉电阻有效；
- 1: 端口内部上拉电阻无效；

下拉电阻控制寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PDCON	-	P12PD	P11PD	P10PD	-	-	-	-
R/W	-	R/W	R/W	R/W	-	-	-	-
初始值	-	1	1	1	-	-	-	-

BIT[6:4] **P1nPD** – P1n 端口下拉电阻控制位 (n=2-0)

0: 端口内部下拉电阻有效;

1: 端口内部下拉电阻无效;

6.3 端口模式控制

用作数字输出口时, 除 P13 固定为开漏输出外, P1 其余端口可选择推挽输出或开漏输出。

端口输出模式寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ODCON	-	-	P15OD	P14OD	-	P12OD	P11OD	P10OD
R/W	-	-	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W
初始值	-	-	0	0	-	0	0	0

BIT[5:4,2:0] **P1nOD** – P1n 端口输出模式选择位 (n=5-4,2-0)

0: 输出时端口为推挽输出;

1: 输出时端口为开漏输出;

注: 开漏输出口输出高电平时, 若端口电压低于 VDD 电压则会产生漏电流。

7 定时器 TIMER

7.1 看门狗定时器 WDT

看门狗定时器 WDT 的时钟源为内部低频 RC 振荡器，可通过预分频器选择不同的计数时钟频率。WDT 计数器溢出将复位芯片或唤醒 CPU。

可通过配置字 WDTM 和寄存器位 WDTEN 共同决定是否开启 WDT。当 WDTM 选择始终关闭或 WDTEN 为 0 时 WDT 定时器被关闭；当 WDTM 选择始终开启且 WDTEN 为 1 时 WDT 定时器才开启。若 WDT 定时器开启，则在休眠模式下 WDT 依然工作，溢出时将唤醒 CPU；而在 CPU 运行时 WDT 溢出，则将复位芯片。

WDT 和定时器 T0 共用一个预分频器，并通过寄存器位决定预分频器的分配。当预分频器分配给 T0 时，WDT 时钟不分频；而预分频器分配给 WDT 时，T0 时钟不分频。

执行 CLRWDT 指令或 STOP 指令将清零 WDT 计数器，若预分频器分配给 WDT，则还将清零预分频计数器（预分频比不变）。

WDT 的基本溢出时间（即无预分频的时间）可配置为 4.5ms/18ms/72ms/288ms。

注：WDT 溢出时间为典型值，实际值偏差大，必须保证清 WDT 时间小于典型值的 1/4。

杂项控制寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
MCR	WDTEN	EIS	LVDF	-	LVDSEL2	LVDSEL1	LVDSEL0	LV DEN
R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	1	0	0	-	0	0	0	0

BIT[7] **WDTEN** – 看门狗使能位

- 0: 关闭 WDT;
- 1: 开启 WDT;

BIT[6] **EIS** – INT 中断外部输入使能位

- 0: INT 中断外部输入无效，端口用作其他功能;
- 1: INT 中断外部输入有效，端口需设为输入;

BIT[5] **LVDF** – LVD 检测状态标志位

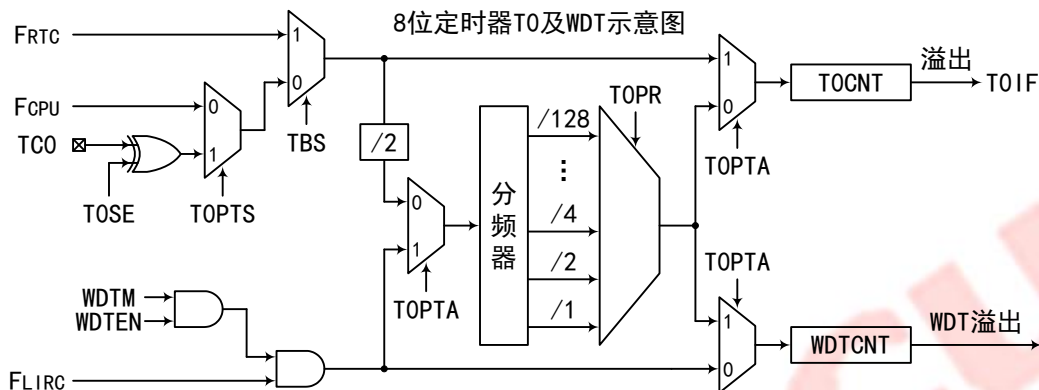
BIT[3:1] **LVDSEL[2:0]** – LVD 电压检测量值选择位

BIT[0] **LV DEN** – 低电压检测 LVD 使能位

7.2 定时器 T0

定时器 T0 为 8 位定时/计数器，包含 1 个 8 位递增计数器、可编程预分频器、控制寄存器。

- ✧ 可通过预分频比设置计数频率；
- ✧ 时钟源可选：FRTC、FCPU、外部时钟（TC0 输入）；
- ✧ 支持溢出中断和溢出唤醒功能；



TOCNT 为 8 位可读写的递增计数器，计数溢出到 0 时产生溢出信号并触发中断，中断标志 T0IF 将被置 1。

预分频器为 T0 与 WDT 共用，通过寄存器位 TOPTA 控制预分频器的分配。TOPTA=0 时，预分频器分配给 T0 使用；TOPTA=1 时，预分频器分配给 WDT 使用。不管预分频器是否分配给 T0，写 TOCNT 都将清零预分频计数器，预分频比保持不变。T0 计数周期 = 预分频比 / T0 计数时钟频率。

当系统时钟通过配置字 OSCM 配置为双时钟模式时，通过 TBS 选择外部 32768Hz 低频晶体振荡器时钟 FRTC 作为 T0 时钟，则在低功耗模式下 T0 将继续工作，溢出可唤醒。

定时器 T0 控制寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T0CR	-	INTOM	TOPTS	T0SE	TOPTA	TOPR2	TOPR1	TOPR0
R/W	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	-	0	1	1	1	1	1	1

BIT[6] **INTOM** – 外部中断 INT 触发方式选择位

- 0: 下降沿触发；
- 1: 上升沿触发；

BIT[5] **TOPTS** – T0 时钟源选择位

- 0: T0 时钟源为 FCPU；
- 1: T0 时钟源为 TC0 输入的外部时钟；

BIT[4] **T0SE** – T0 外部时钟计数沿选择位

- 0: 外部时钟上升沿计数；
- 1: 外部时钟下降沿计数；

BIT[3] **T0PTA** – 预分频器分配控制位

0: 预分频器分配给 T0;

1: 预分频器分配给 WDT;

BIT[2:0] **T0PR[2:0]** – 预分频比选择位

T0PR[2:0]	T0 时钟预分频比 (T0PTA=0)	WDT 时钟预分频比 (T0PTA=1)
000	1: 2	1: 1
001	1: 4	1: 2
010	1: 8	1: 4
011	1: 16	1: 8
100	1: 32	1: 16
101	1: 64	1: 32
110	1: 128	1: 64
111	1: 256	1: 128

定时器 T0 计数器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T0CNT	T0C7	T0C6	T0C5	T0C4	T0C3	T0C2	T0C1	T0C0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	X	X	X	X	X	X	X	X

BIT[7:0] **T0C[7:0]** – T0 计数器，为可读写的递增计数器

定时器控制寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TM0CR	TBS	-	-	-	-	-	T1IE	T1IF
R/W	R/W	-	-	-	-	-	R/W	R/W
初始值	0	-	-	-	-	-	0	0

BIT[7] **TBS** – T0 时钟源选择位

0: T0 时钟源由 T0PTS 决定;

1: T0 时钟源为外部 32768Hz 低频晶体振荡器时钟 FRTC;

BIT[1] **T1IE** – 定时器 T1 中断使能位

0: 屏蔽定时器 T1 中断;

1: 使能定时器 T1 中断;

BIT[0] **T1IF** – 定时器 T1 中断标志位

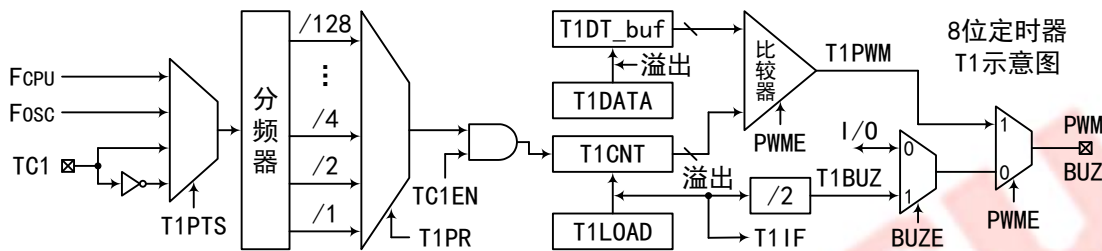
0: 未触发定时器 T1 中断;

1: 已触发定时器 T1 中断，需软件清 0;

7.3 定时器 T1

定时器 T1 为 8 位定时/计数器，包含 1 个 8 位递减计数器、可编程预分频器、控制寄存器、8 位重载寄存器及比较寄存器。

- ✧ 可通过预分频比设置计数频率，可通过重载寄存器控制计数周期；
- ✧ 支持 8 位 PWM 输出，可通过比较寄存器设置 PWM 占空比；
- ✧ 支持 BUZ 输出；
- ✧ 支持溢出中断和溢出唤醒功能；



注：当系统主时钟源为 HIRC 时，T1 时钟源选择 Fosc，则将直接使用 16MHz 的 F_{HIRC}，不受配置字 HIRCFS 的影响。

定时器 T1，可通过寄存器位 T1PTS 选择时钟源，通过 T1PR 选择预分频比，所选时钟源通过预分频器后产生 T1 计数器 T1CNT 的计数时钟（上升沿计数）。预分频比可选择 1~128 分频，对 T1CNT 的写操作将清零预分频计数器，而预分频比保持不变。

当 TC1EN=0 时，T1CNT 保持不变，写重载寄存器 T1LOAD 将立即载入 T1CNT 中；当 TC1EN=1 时，T1CNT 递减计数，计数到 0 的时钟结束后产生溢出信号并触发中断，中断标志 T1IF 将被置 1，同时 T1 自动将当前 T1LOAD 值载入 T1CNT 中重新开始计数。

如图所示，定时器 T1 可实现 BUZ 功能，当 BUZE=1 时，端口将输出频率为 T1 溢出频率 2 分频的蜂鸣器驱动信号（需 PWME=0）。

如图所示，定时器 T1 可实现 PWM 功能，可通过寄存器位使能/关闭 PWM 功能，或控制端口是否输出 PWM 波形。PWM 关闭时 T1PWM 信号为低电平。PWM 使能后，T1CNT 从重载值开始递减计数直到计数溢出为一个 PWM 周期：当计数到与比较寄存器 T1DATA 相等时，T1PWM 变为高电平；当计数溢出时，T1PWM 变为低电平。

T1DATA 配有 1 个 8 位的比较缓冲器（T1DT_buf）用于与 T1CNT 比较，PWM 关闭时写 T1DATA 将立即载入比较缓冲器中，而 PWM 使能后写 T1DATA 则将在 T1 溢出时才载入比较缓冲器中。若要首个 PWM 周期和占空比准确，需先写重载寄存器和比较寄存器，再使能 PWM，最后开启定时器。

T1PWM 信号的占空比计算如下：

- ✧ 高电平时间 = (T1DATA) × T1CNT 计数时钟周期
- ✧ 周期（T1 的溢出周期）= (T1LOAD+1) × T1CNT 计数时钟周期
- ✧ 占空比 = 高电平时间 / 周期 = (T1DATA) / (T1LOAD+1)

定时器 T1 控制寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T1CR	TC1EN	PWME	BUZE	T1PTS1	T1PTS0	T1PR2	T1PR1	T1PR0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7] **TC1EN** – 定时器 T1 使能位

0: 关闭定时器 T1;

1: 开启定时器 T1;

BIT[6] **PWME** – PWM 使能位及端口输出控制位

0: 关闭 PWM 功能, 并禁止端口输出 PWM 波形;

1: 使能 PWM 功能, 并允许端口输出 PWM 波形;

BIT[5] **BUZE** – BUZ 端口输出使能位

0: 禁止端口输出 BUZ 波形;

1: 允许端口输出 BUZ 波形 (仅 PWME=0 时有效);

BIT[4:3] **T1PTS[1:0]** – T1 时钟源选择位

T1PTS[1:0]	T1 时钟源
00	FCPU
01	Fosc
10	TC1 上升沿
11	TC1 下降沿

BIT[2:0] **T1PR[2:0]** – T1 预分频比选择位

T1PR[2:0]	T1 时钟预分频比
000	1: 1
001	1: 2
010	1: 4
011	1: 8
100	1: 16
101	1: 32
110	1: 64
111	1: 128

定时器 T1 计数器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T1CNT	T1C7	T1C6	T1C5	T1C4	T1C3	T1C2	T1C1	T1C0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	1	1	1	1	1	1	1	1

BIT[7:0] **T1C[7:0]** – T1 计数器, 为可读写的递减计数器

定时器 T1 重载寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T1LOAD	T1LOAD7	T1LOAD6	T1LOAD5	T1LOAD4	T1LOAD3	T1LOAD2	T1LOAD1	T1LOAD0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	1	1	1	1	1	1	1	1

BIT[7:0] **T1LOAD[7:0]** – T1 重载寄存器，用于设置 T1 的计数周期

注：定时器重载寄存器的值禁止为 0，否则定时器将无法正常工作。

定时器 T1 比较寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T1DATA	T1DATA7	T1DATA6	T1DATA5	T1DATA4	T1DATA3	T1DATA2	T1DATA1	T1DATA0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] **T1DATA[7:0]** – T1 比较寄存器，用于设置 PWM 的占空比

8 低电压检测 LVD

芯片内置低电压检测模块 LVD，可通过寄存器位 LVDEN 开启，通过 LVDSEL 选择电压检测量值。当 VDD 电压低于电压检测量值时检测状态标志位 LVDF 将被置 1；因 LVD 电路有回滞特性（回滞电压典型值为 6%），VDD 电压需上升至电压检测量值+6%后 LVDF 才被清 0。

注：开启 LVD、切换电压检测量值等操作，需待电路稳定（时间>2ms）后 LVD 输出才有效。

杂项控制寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
MCR	WDTEN	EIS	LVDF	-	LVDSEL2	LVDSEL1	LVDSEL0	LVDEN
R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	1	0	0	-	0	0	0	0

BIT[7] **WDTEN** – 看门狗使能位

BIT[6] **EIS** – INT 中断外部输入使能位

BIT[5] **LVDF** – LVD 检测状态标志位
0: VDD 电压高于电压检测量值，或 LVD 关闭；
1: VDD 电压低于电压检测量值；

BIT[3:1] **LVDSEL[2:0]** – LVD 电压检测量值选择位

LVDSEL[2:0]	LVD 电压检测量值
000	1.8V
001	2.4V
010	3.0V
011	3.3V
100	3.6V
101	3.8V
110	4.0V
111	

BIT[0] **LVDEN** – 低电压检测 LVD 使能位
0: 关闭 LVD；
1: 开启 LVD；

9 中断

芯片的中断源包括外部中断（INT）、定时器中断（T0~T1）和键盘中断等。可通过中断总使能位 GIE 屏蔽所有中断。

CPU 响应中断的过程如下：

- ✧ CPU 响应中断源触发的中断请求时，自动将当前指令的下一条要执行指令的地址压栈保存，自动清 0 中断总使能位 GIE 以暂停响应后续中断。与复位不同，硬件中断不停止当前指令的执行，而是暂时挂起中断直到当前指令执行完成。
- ✧ CPU 响应中断后，程序跳到中断入口地址（0008H）开始执行中断服务程序，中断服务程序应先保存累加器 A 和状态寄存器 STATUS，然后处理被触发的中断。
- ✧ 中断服务程序处理完中断后，应先恢复累加器 A 和状态寄存器 STATUS，然后执行 RETIE 返回主程序。此时芯片将自动恢复 GIE 为 1，然后从堆栈取出 PC 值，从中断产生时当前指令的下一条指令继续执行。

注：要使用外部中断功能或键盘中断功能，需将相应端口设为输入状态。

9.1 外部中断

芯片有 1 路外部中断源 INT，通过 INTOM 可选择上升沿或下降沿等触发方式。外部中断触发时，中断标志 INTIF 将被置 1，若中断总使能位 GIE 为 1 且外部中断使能位 INTIE 为 1，则产生外部中断。

注：当 P10 端口通过寄存器位 EIS 置 1 复用为 INT 时，端口的键盘中断唤醒功能无效。

9.2 定时器中断

定时器 Tn（n=0-1）在计数溢出时触发定时器中断，中断标志 TnIF（n=0-1）将被置 1，若中断总使能位 GIE 为 1 且定时器中断使能位 TnIE（n=0-1）为 1，则产生定时器中断。

9.3 键盘中断

芯片有 6 路键盘中断源，均可通过寄存器位单独使能或屏蔽，任意一路使能的中断源的输入电平发生变化时，均会触发键盘中断，中断标志 KBIF 将被置 1，若中断总使能位 GIE 为 1 且键盘中断使能位 KBIE 为 1，则产生键盘中断。

键盘中断控制寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
KBIM	-	-	KBIM5	KBIM4	KBIM3	KBIM2	KBIM1	KBIM0
R/W	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	-	-	0	0	0	0	0	0

BIT[5:0] **KBIMn** – P1n 端口键盘中断使能位 (n=5-0)

0: 屏蔽端口键盘中断功能;

1: 使能端口键盘中断功能;

9.4 中断相关寄存器

中断使能寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
INTECON	GIE	-	-	-	-	INTIE	KBIE	TOIE
R/W	R/W	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
初始值	0	-	-	-	-	0	0	0

BIT[7] **GIE** – 中断总使能位

0: 屏蔽所有中断;

1: 由相应的中断使能位决定 CPU 是否响应中断源所触发的中断;

BIT[2] **INTIE** – INT 中断使能位

0: 屏蔽 INT 中断;

1: 使能 INT 中断;

BIT[1] **KBIE** – 键盘中断使能位

0: 屏蔽键盘中断;

1: 使能键盘中断;

BIT[0] **TOIE** – 定时器 T0 中断使能位

0: 屏蔽定时器 T0 中断;

1: 使能定时器 T0 中断;

中断标志寄存器

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
INTFLAG	-	-	-	-	-	INTIF	KBIF	TOIF
R/W	-	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
初始值	-	-	-	-	-	0	0	0

BIT[2] **INTIF** – INT 中断标志位

0: 未触发 INT 中断;

1: 已触发 INT 中断, 需软件清 0;

- BIT[1] **KBIF** – 键盘中断标志位
0: 未触发键盘中断;
1: 已触发键盘中断, 需软件清 0;
- BIT[0] **T0IF** – 定时器 T0 中断标志位
0: 未触发定时器 T0 中断;
1: 已触发定时器 T0 中断, 需软件清 0;

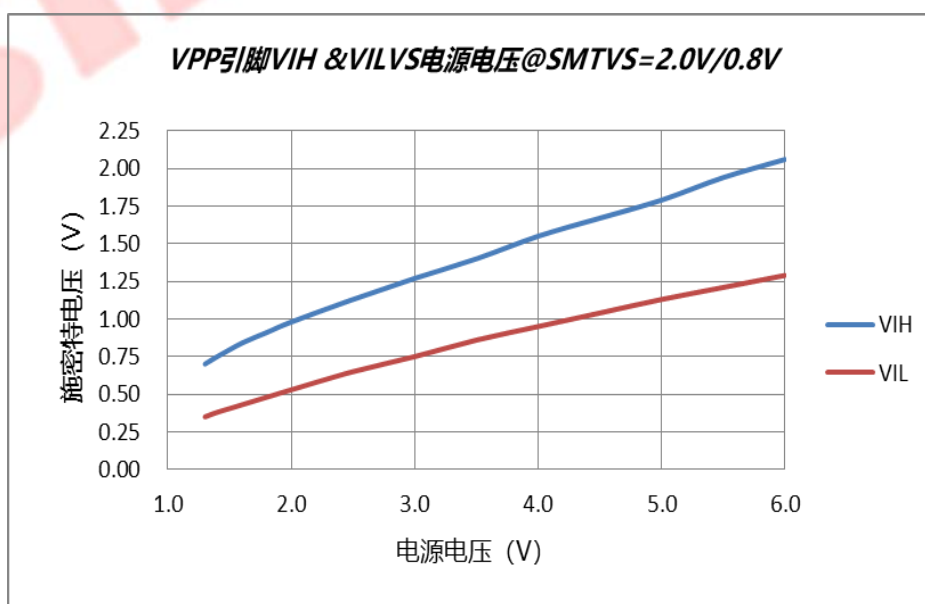
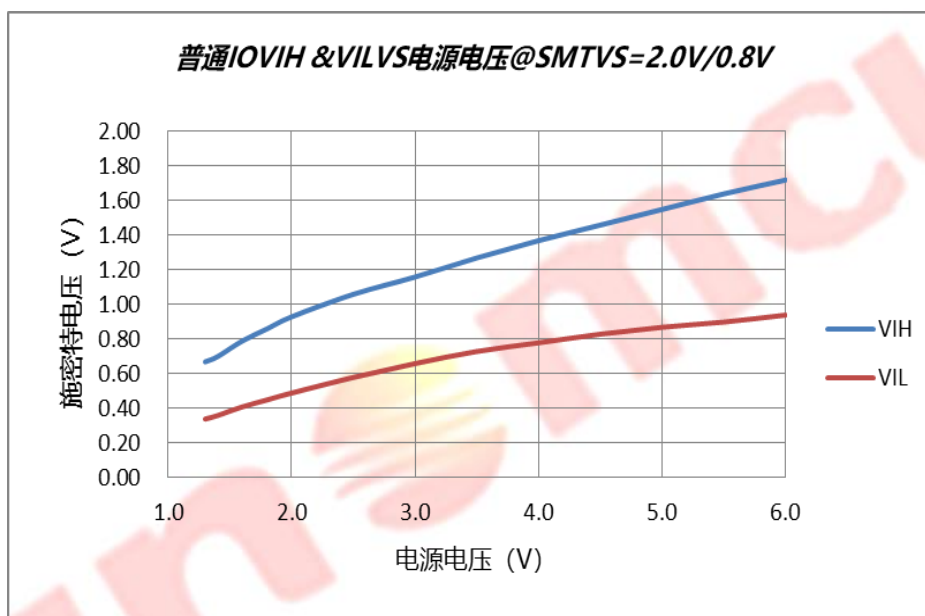
10 特性曲线

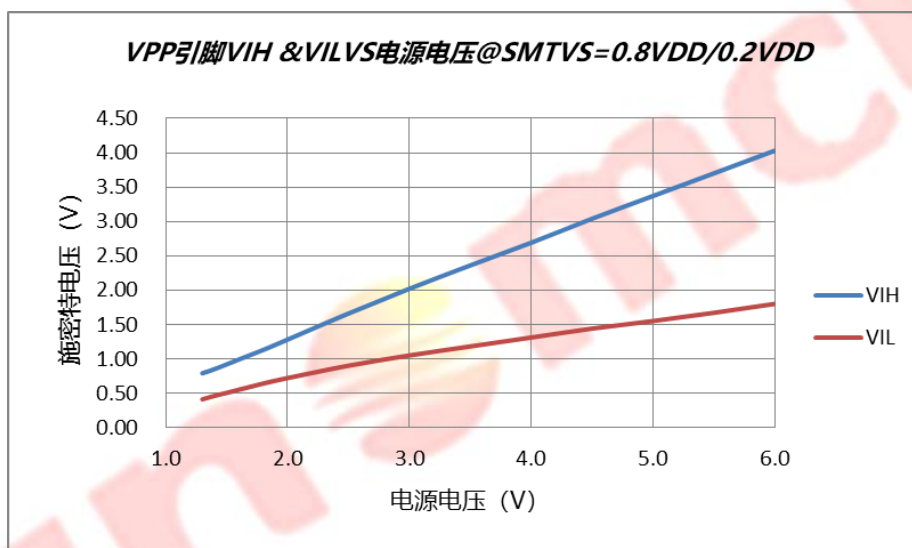
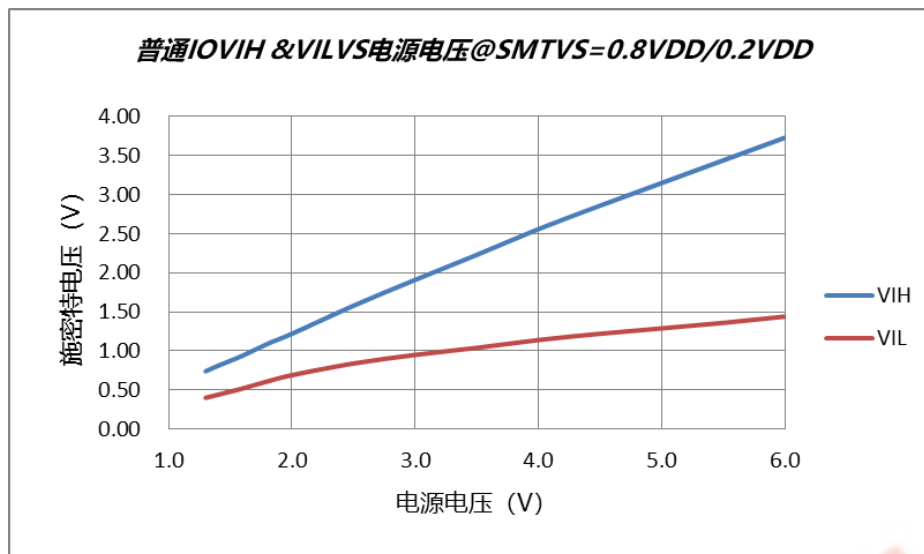
注:

- 1、特性曲线图中数据均来自抽样实测，仅作为应用参考，部分数据因生产工艺偏差，可能与实际芯片不符；为保证芯片能正常工作，请确保其工作条件符合电气特性参数说明；
- 2、若图文中无特别说明，则电压特性曲线的温度条件为 $T=25^{\circ}\text{C}$ ，温度特性曲线的电压条件为 $V_{DD}=5\text{V}$ ；

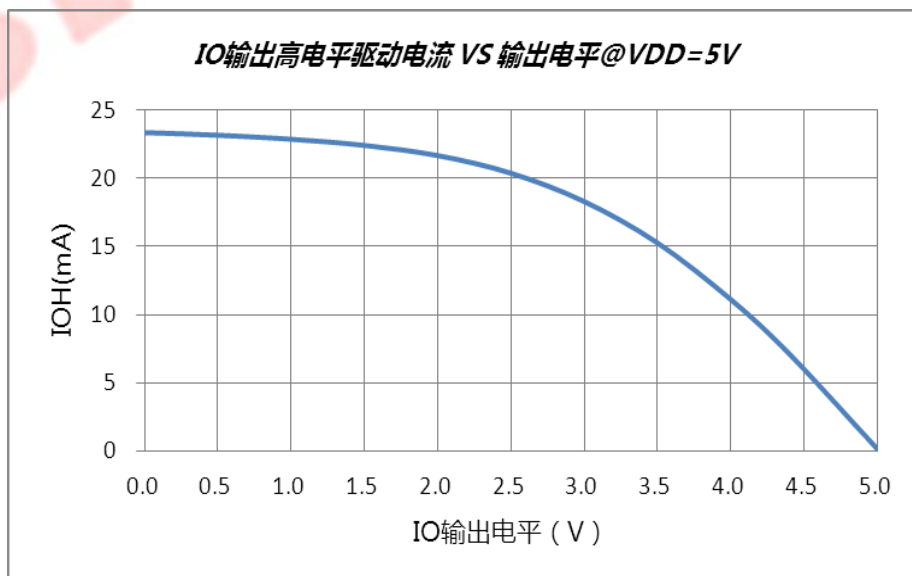
10.1 I/O 特性

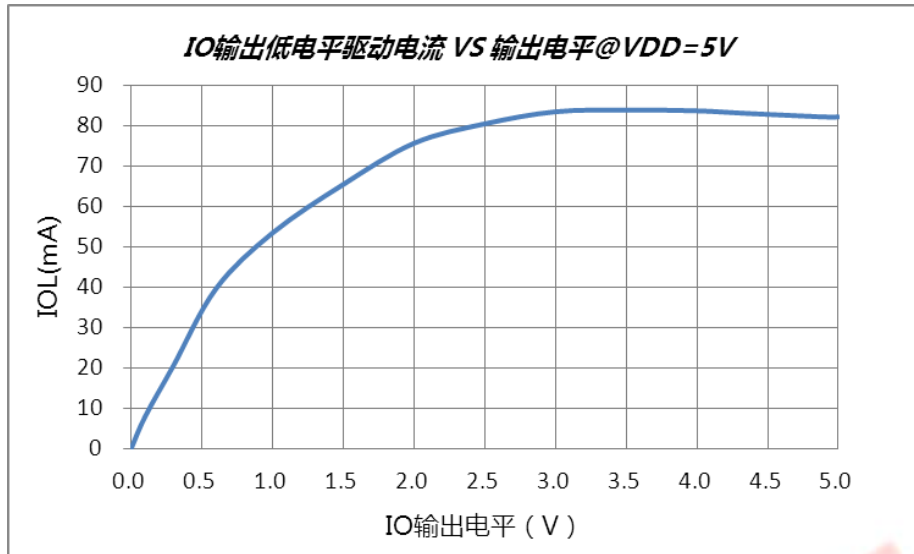
输入 SMT 阈值电压 VS 电源电压



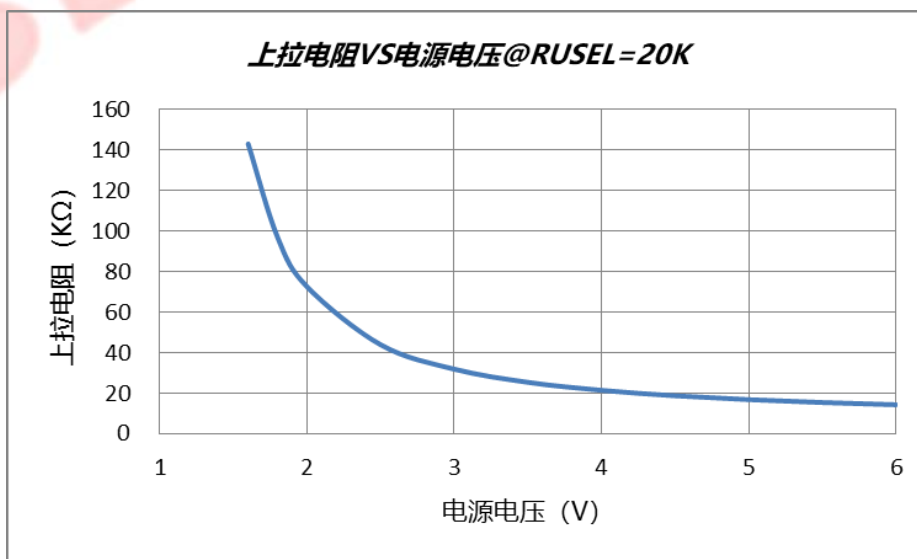
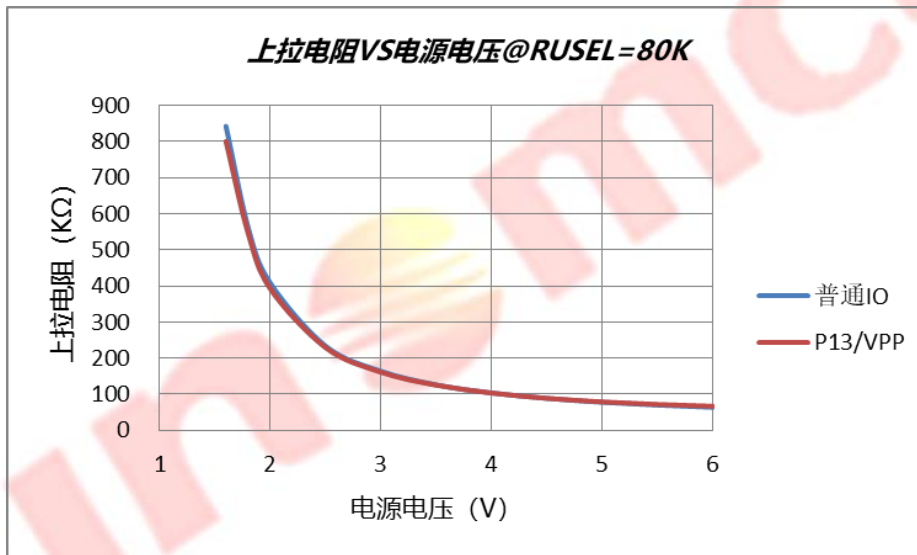


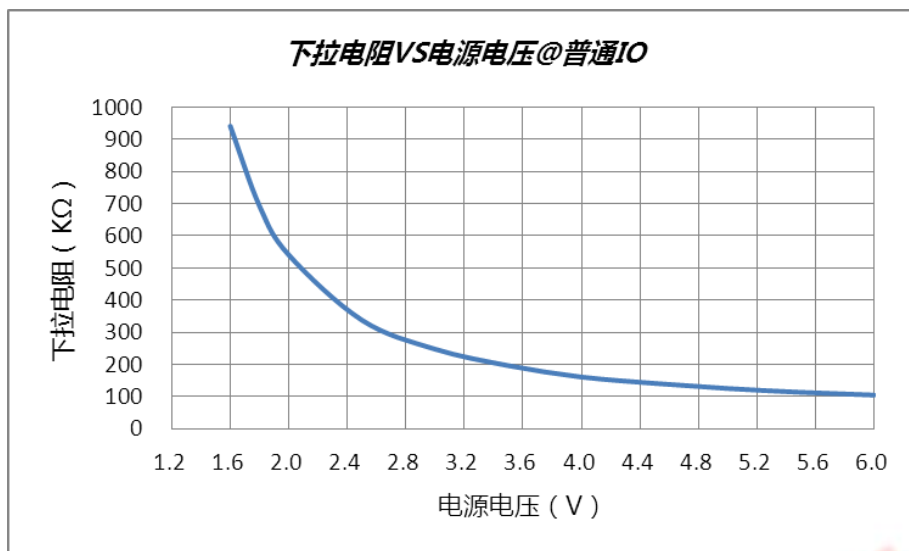
I/O 输出 驱动电流 VS 端口电压 (VDD=5V)





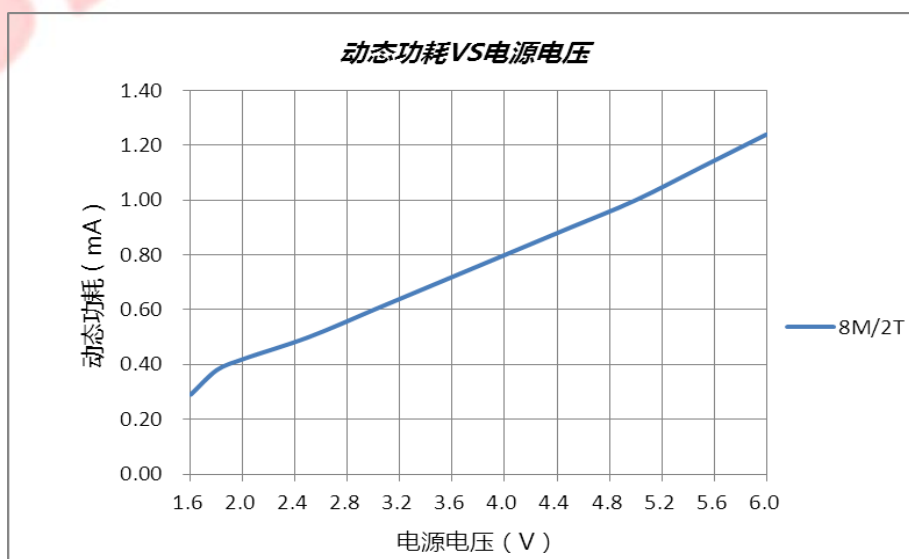
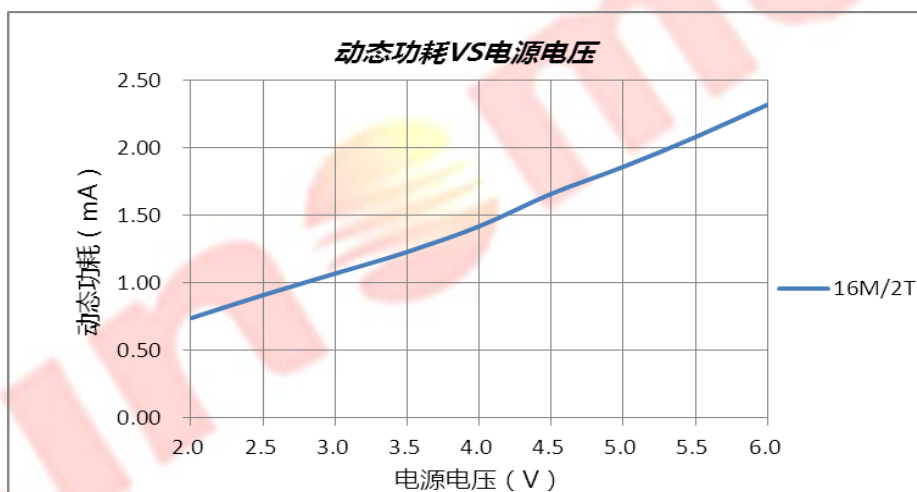
上/下拉电阻值 VS 电源电压

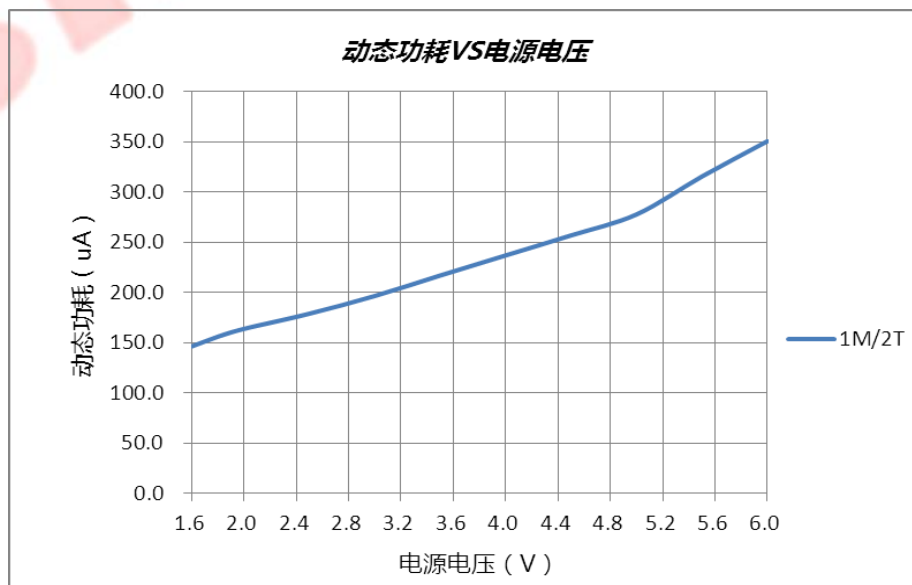
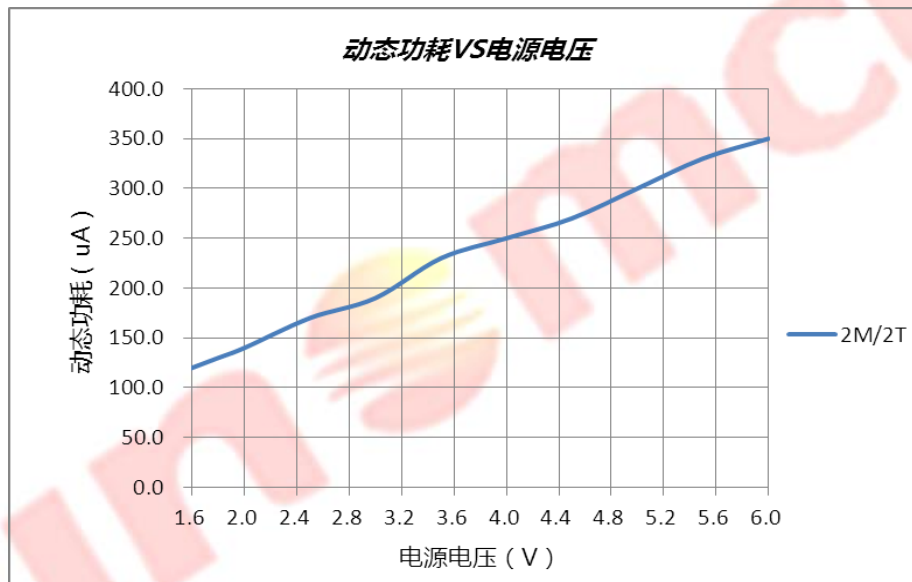
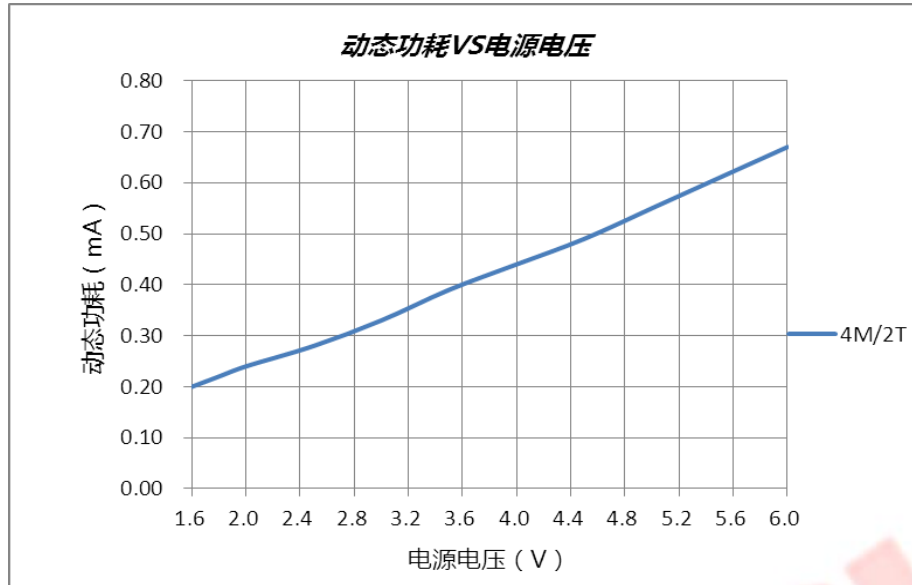


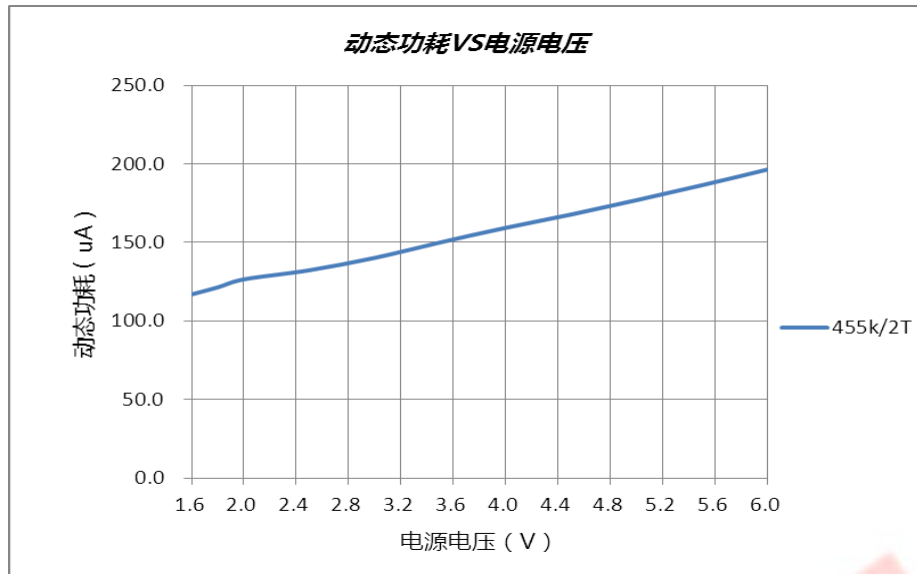


10.2 功耗特性

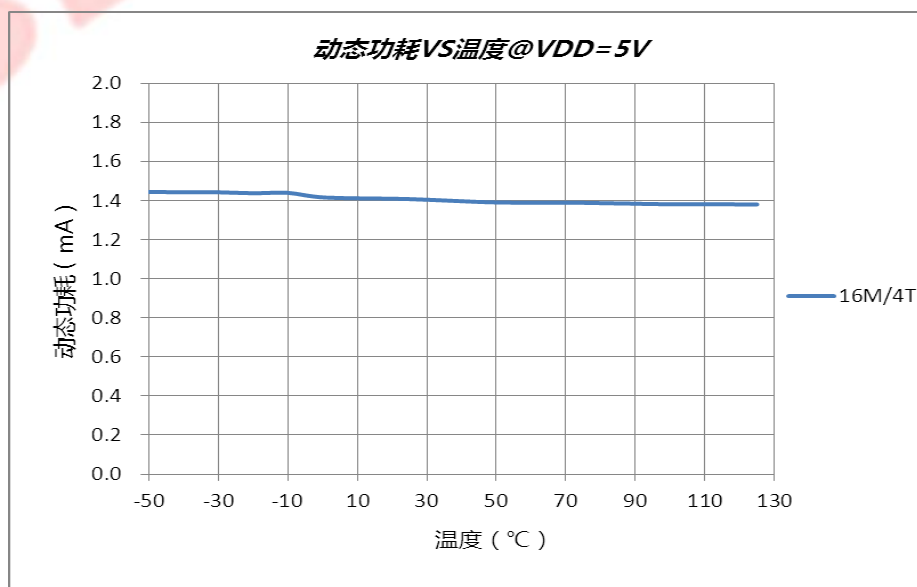
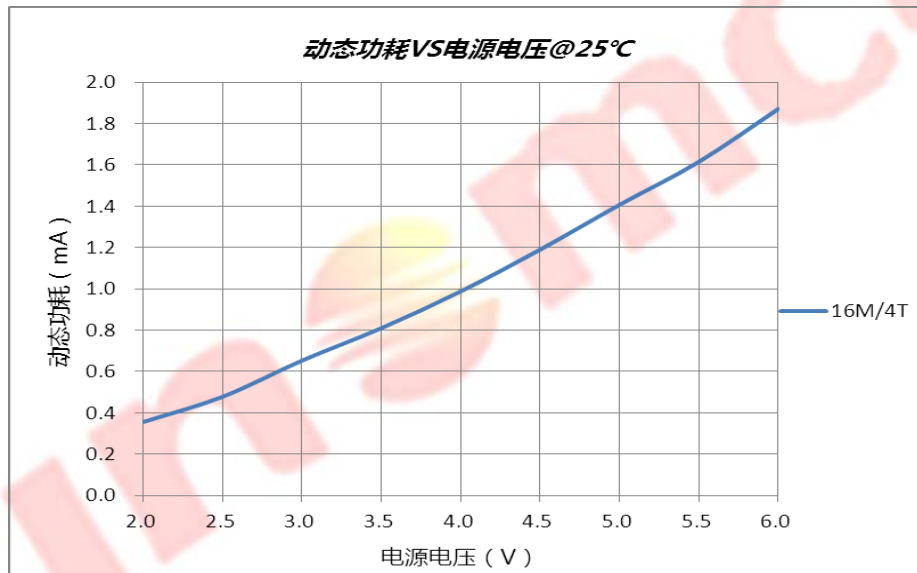
运行模式@HIRC 功耗 VS 电源电压

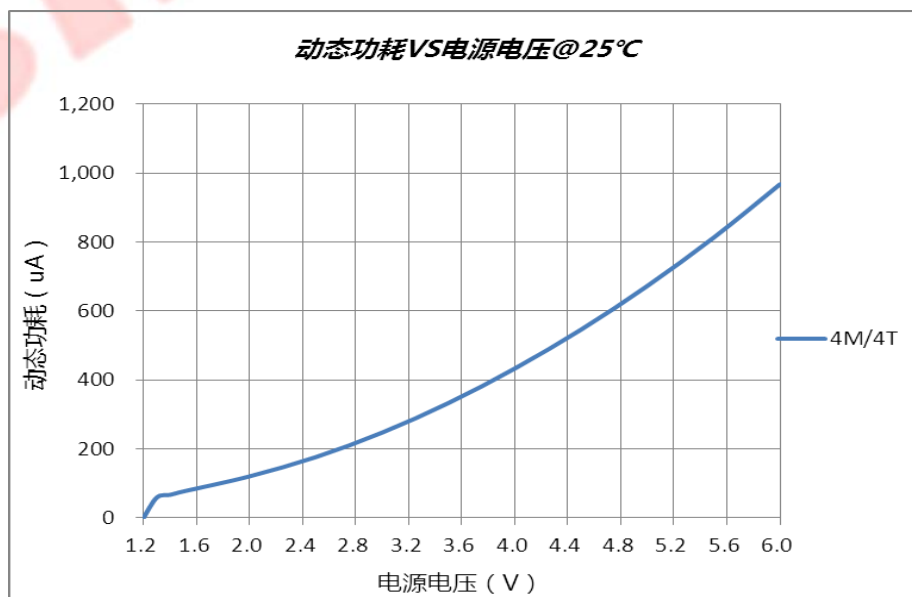
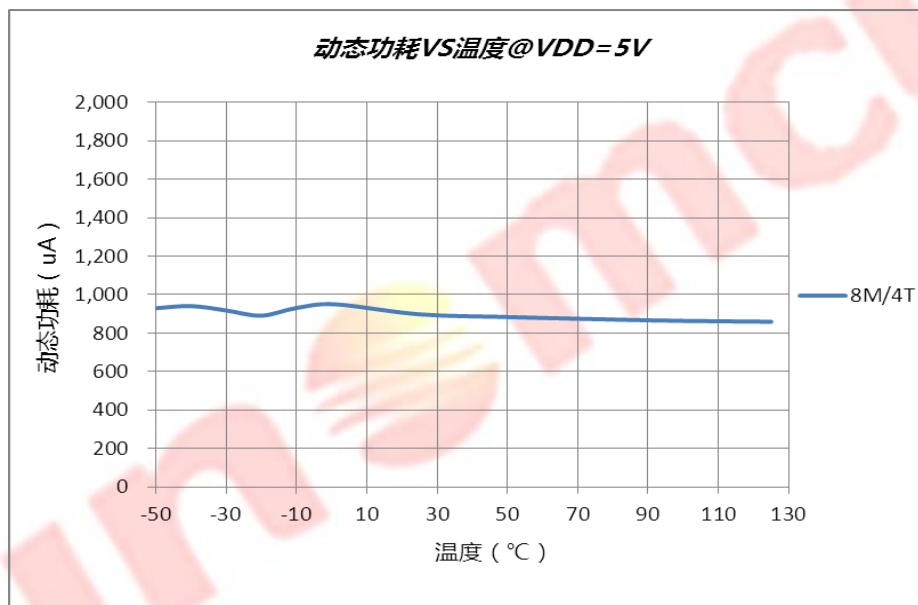
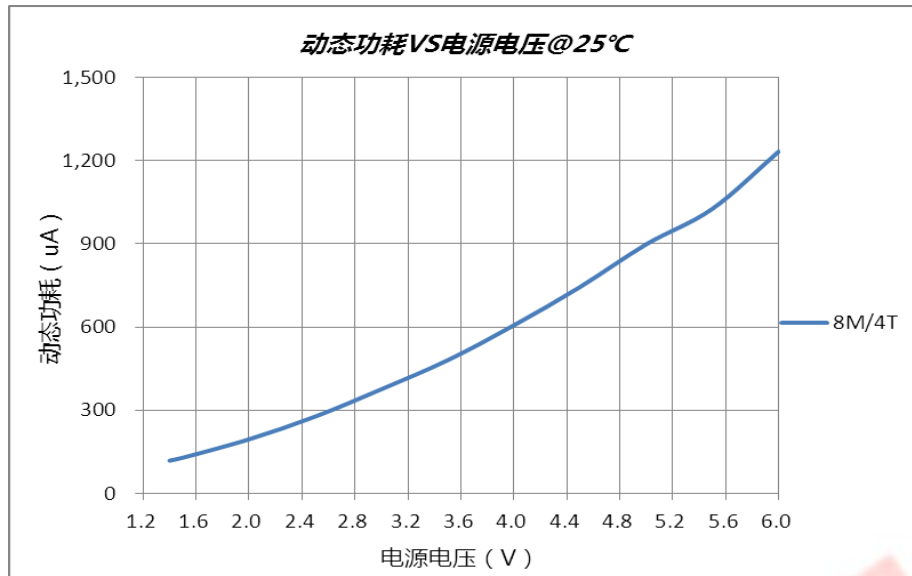


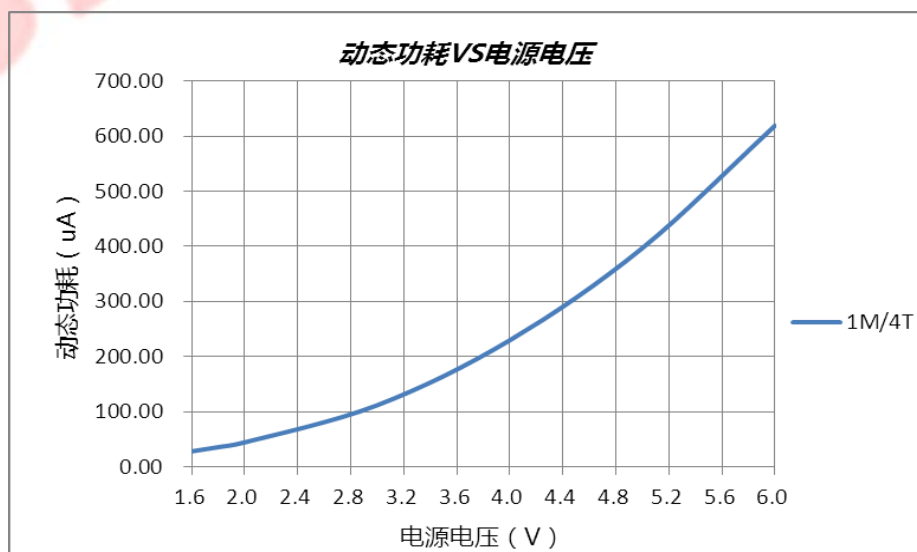
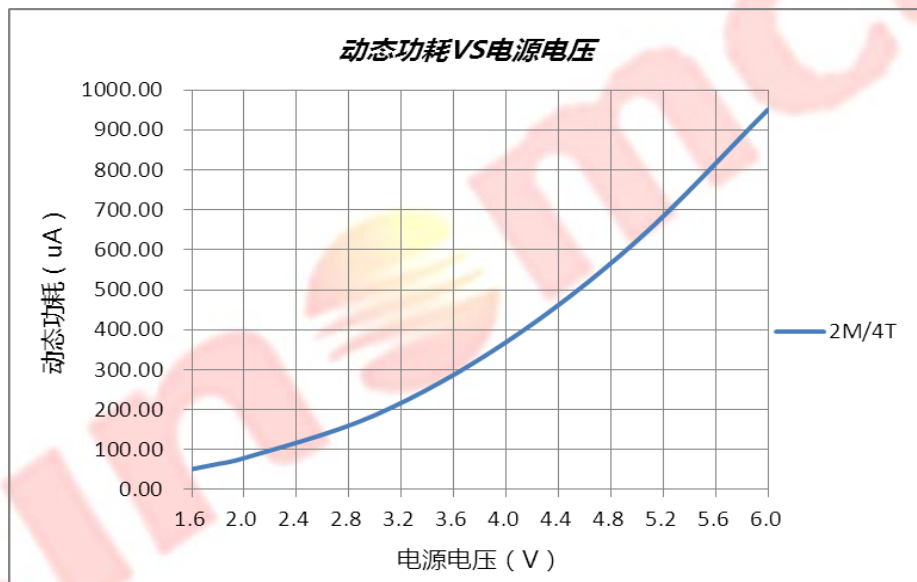
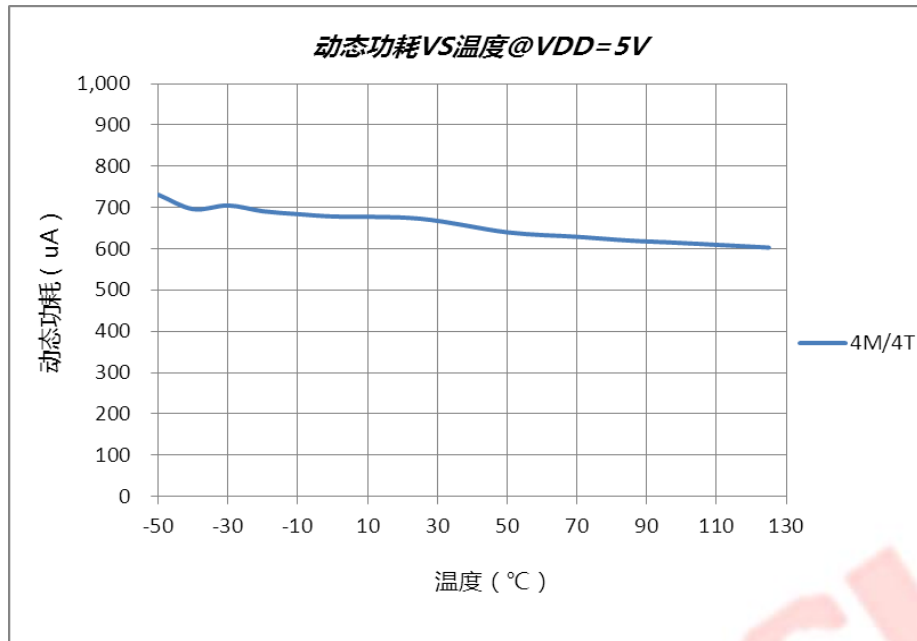


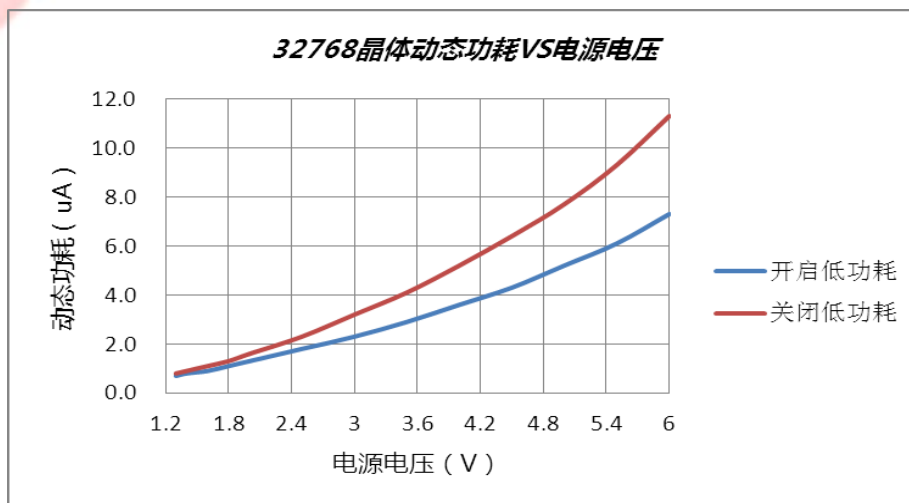
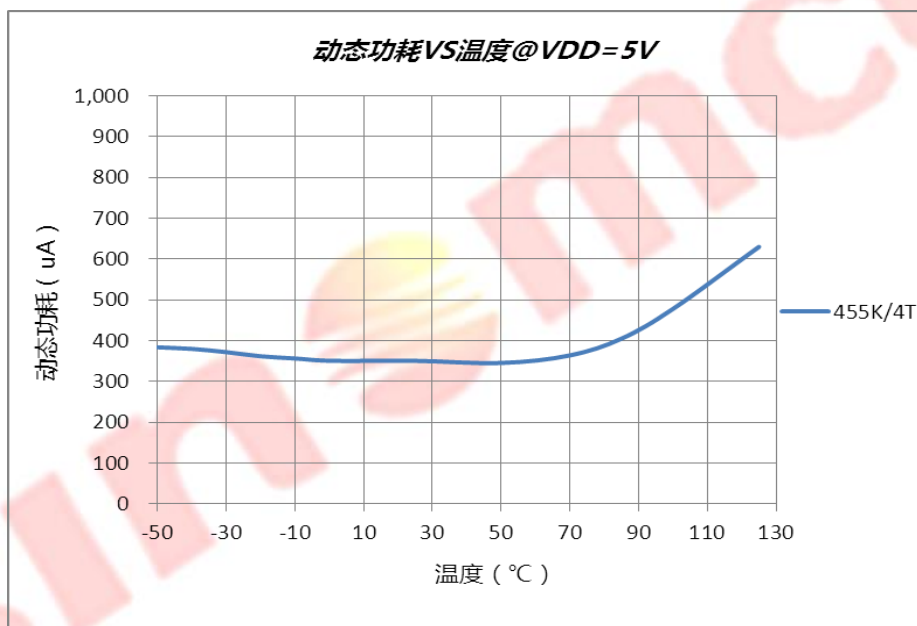
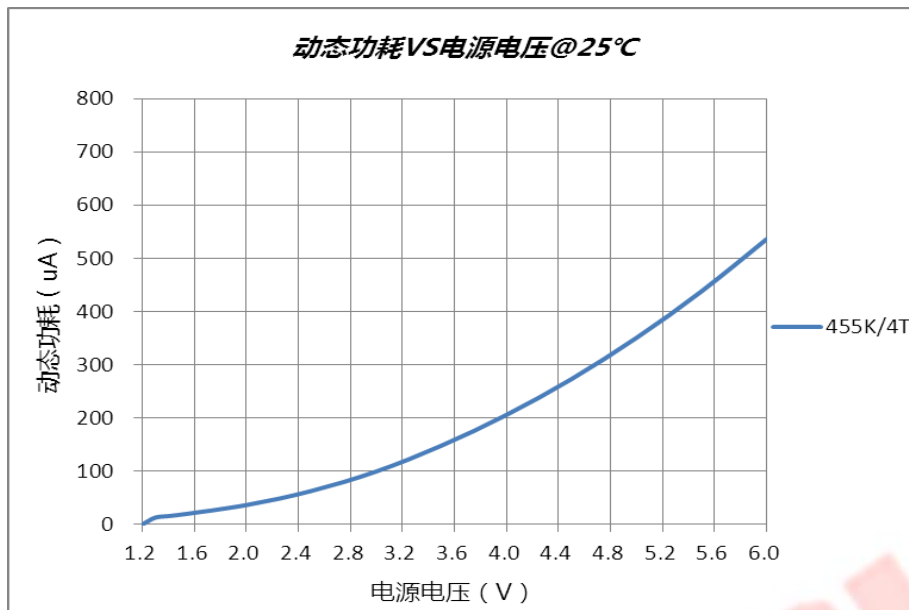


运行模式@外部晶振 功耗 VS 电源电压/温度

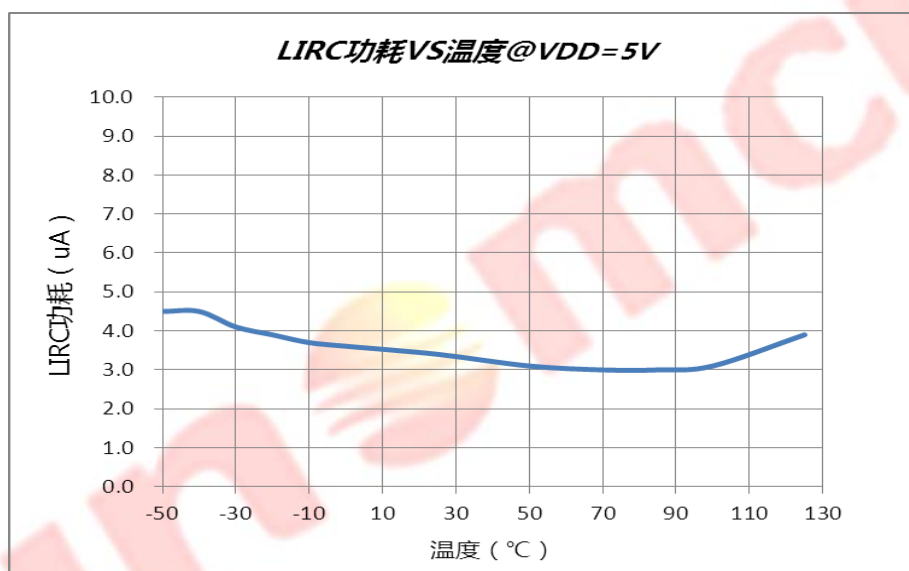
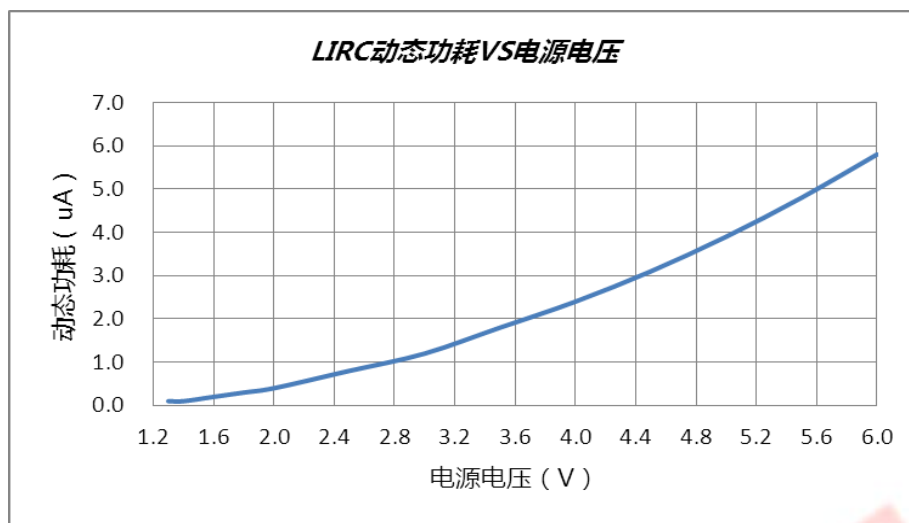




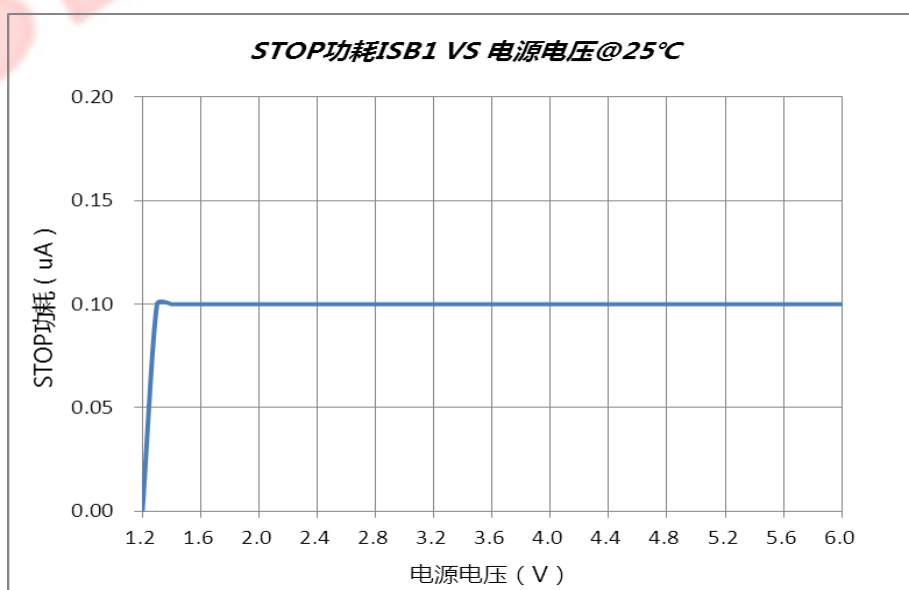


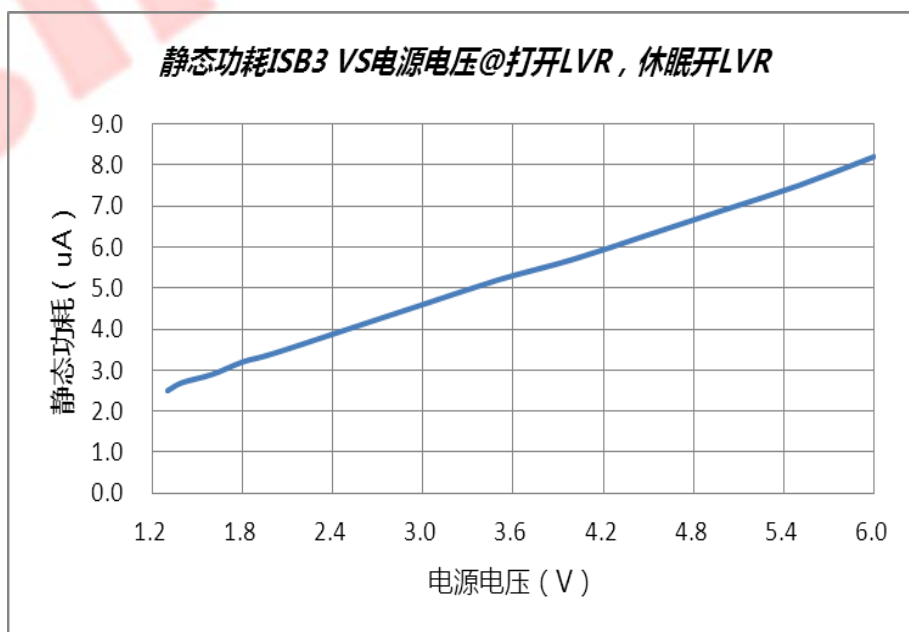
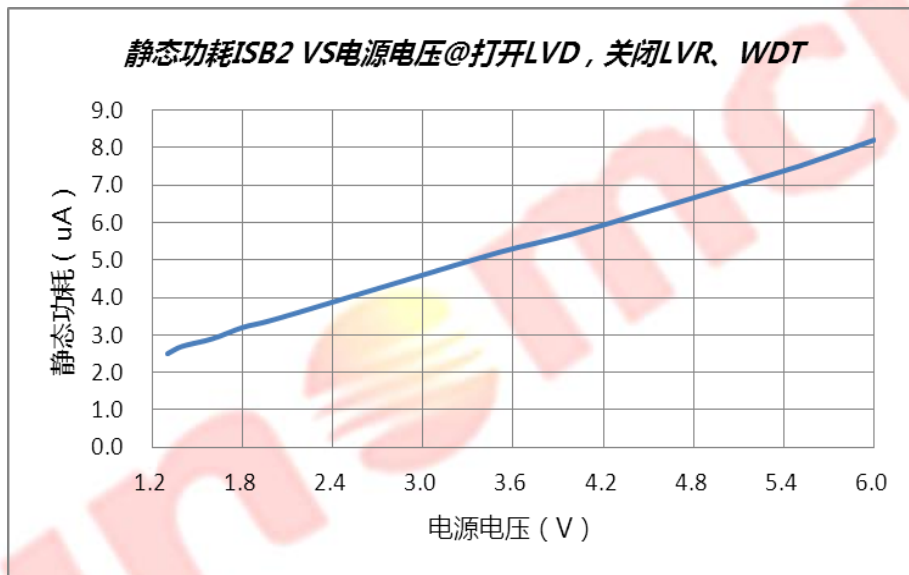
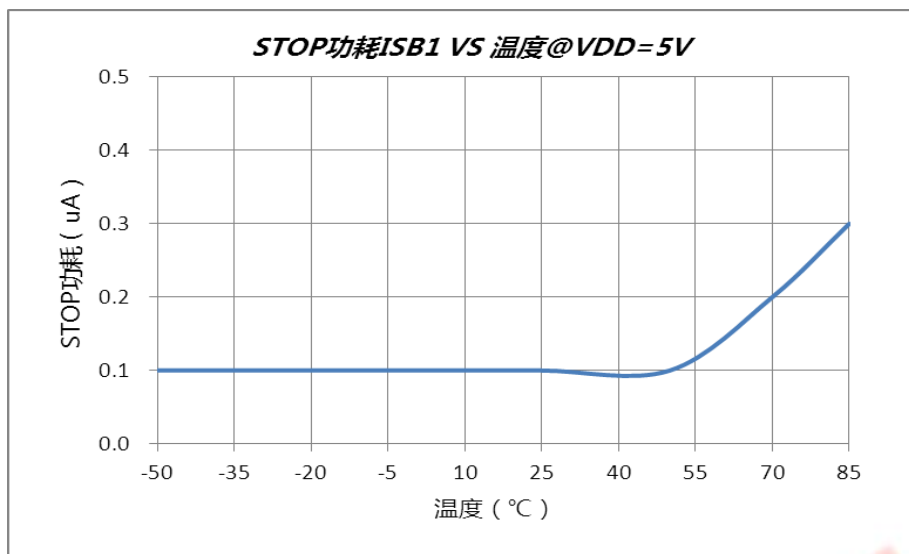


运行模式@LIRC 功耗 VS 电源电压/温度

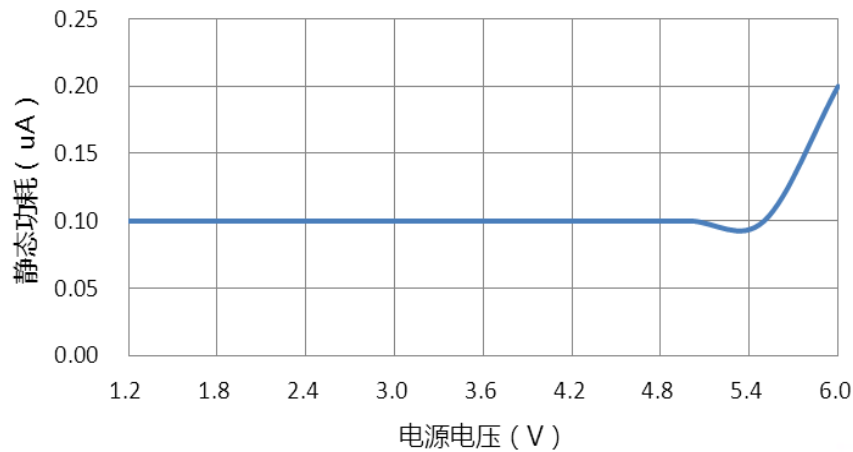


休眠模式 功耗 VS 电源电压/温度

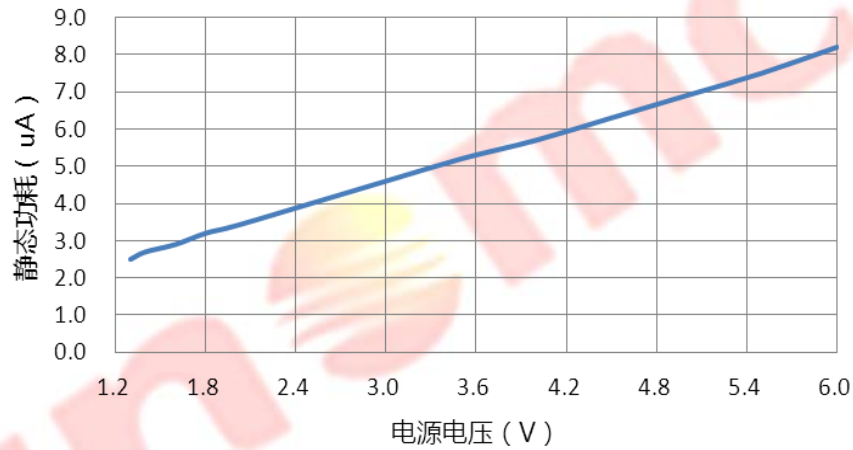




静态功耗ISB3 VS电源电压@打开LVR, 休眠关闭LVR

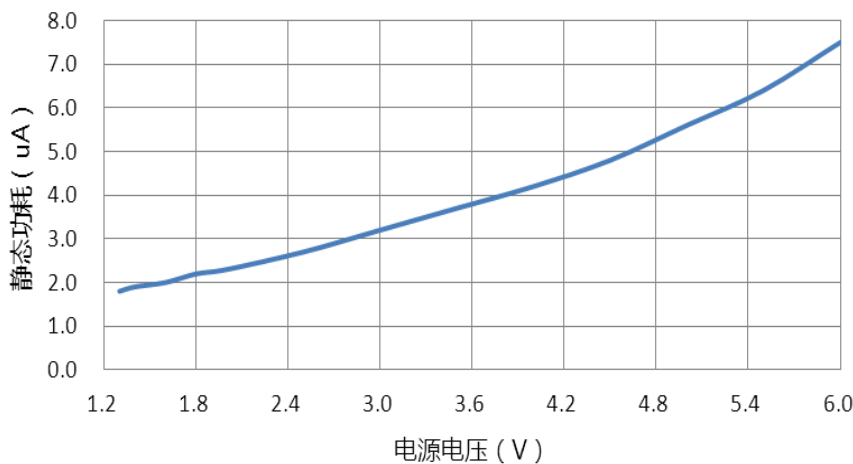


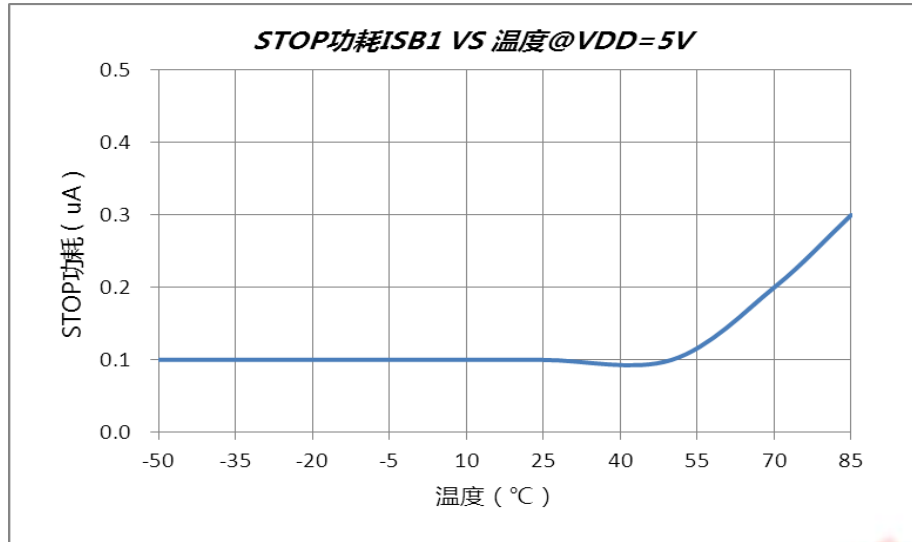
静态功耗ISB4 VS电源电压@打开LVR, LVD



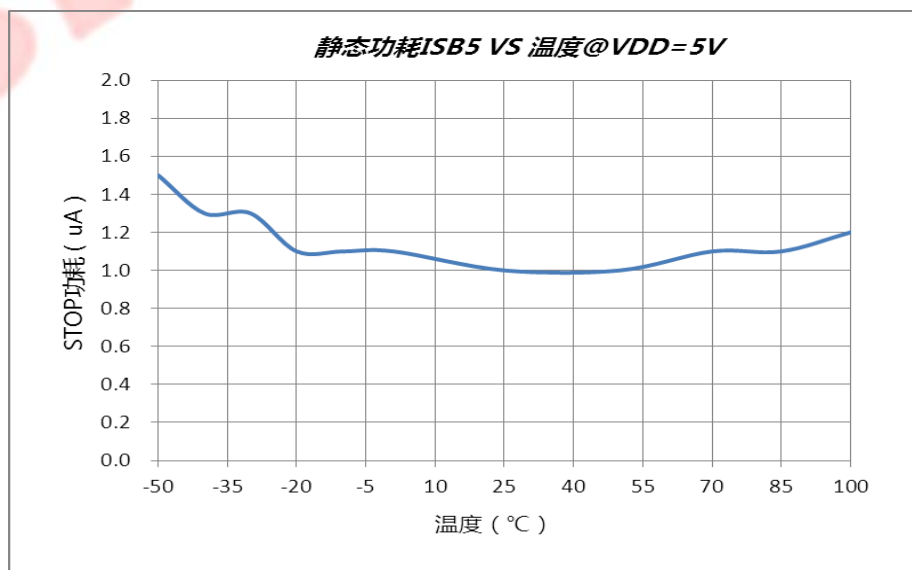
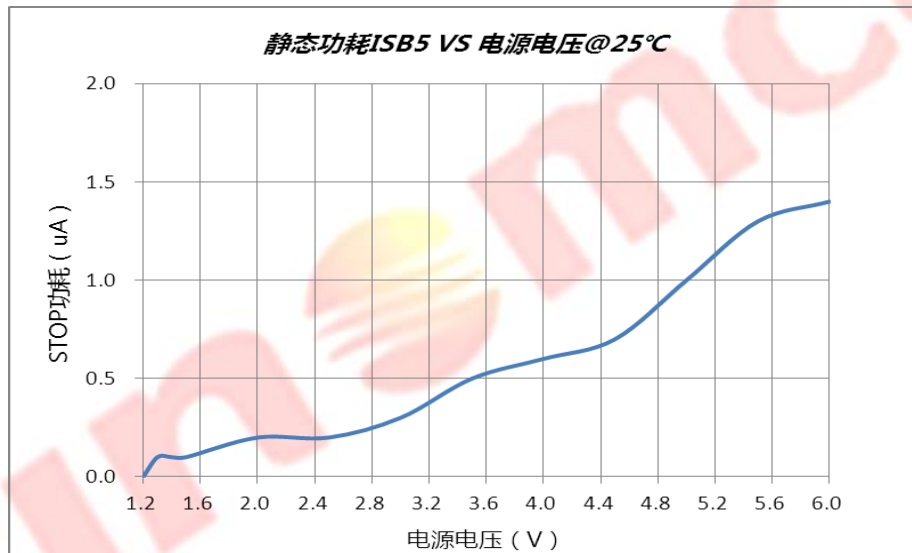
休眠模式@双时钟模式 功耗 VS 电源电压/温度

RTC模式静态功耗ISB6 VS电源电压@RTC模式



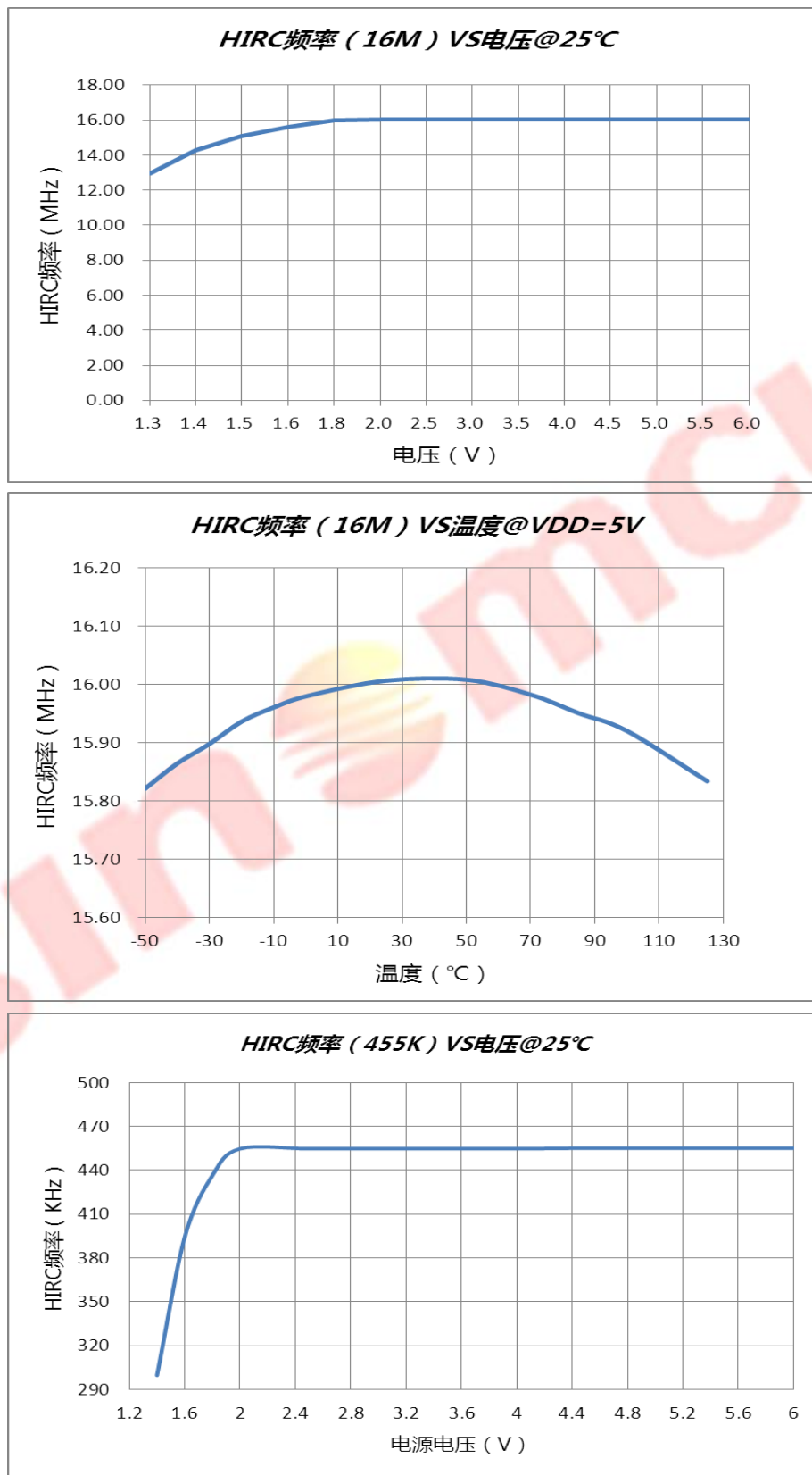


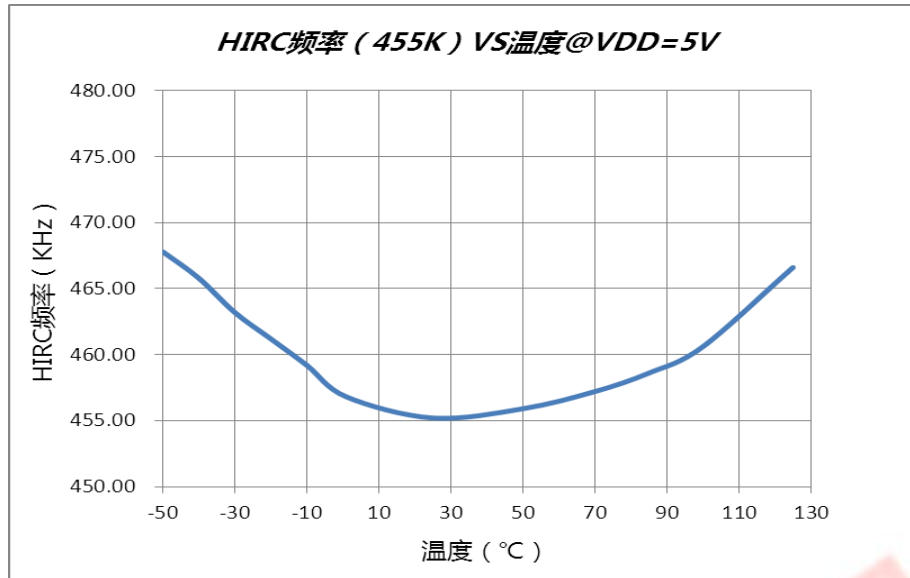
WDT 功耗 VS 电源电压/温度



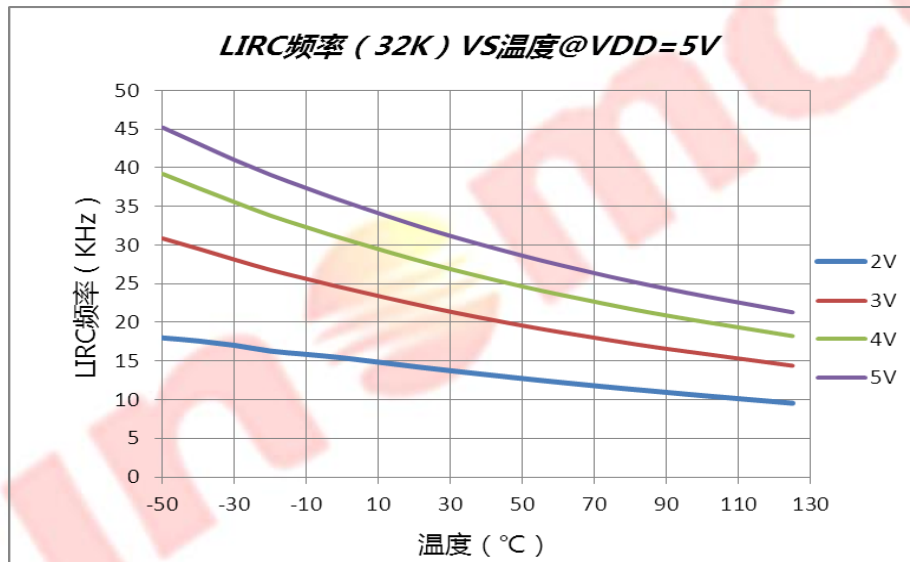
10.3 模拟电路特性

HIRC 频率 VS 电源电压/温度

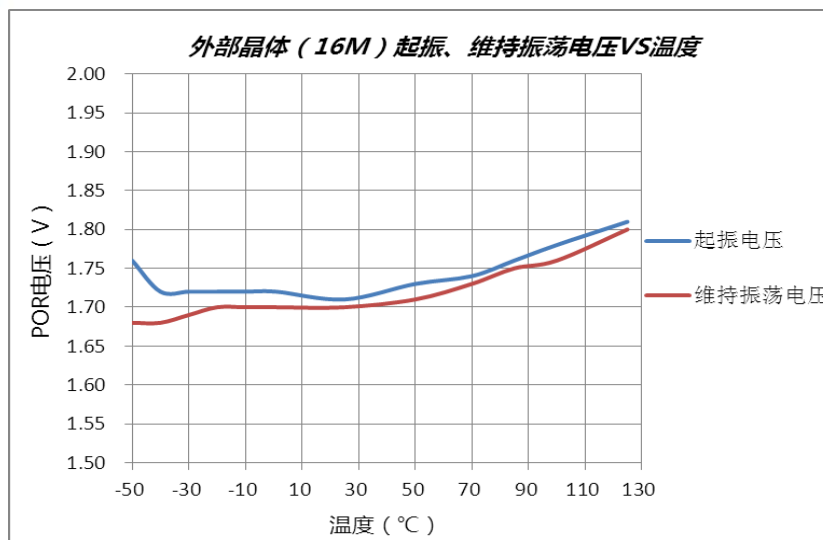


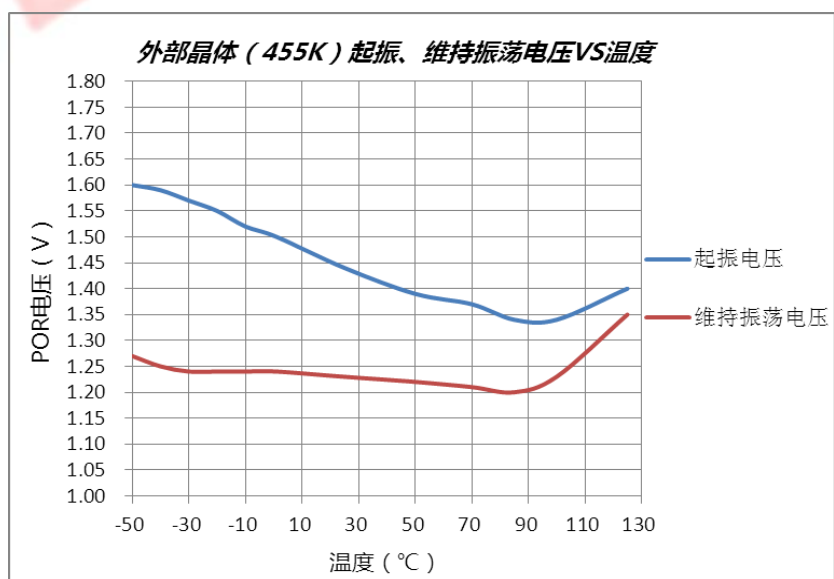
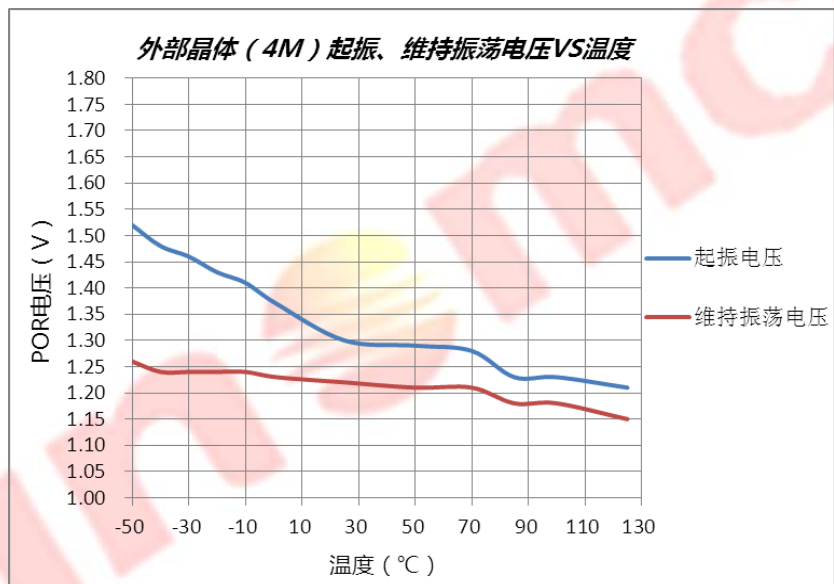
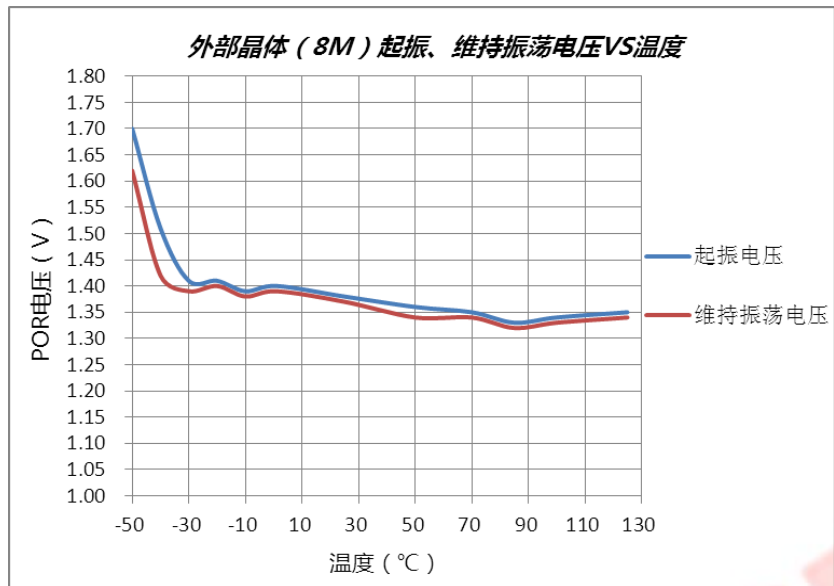


LIRC 频率 VS 温度

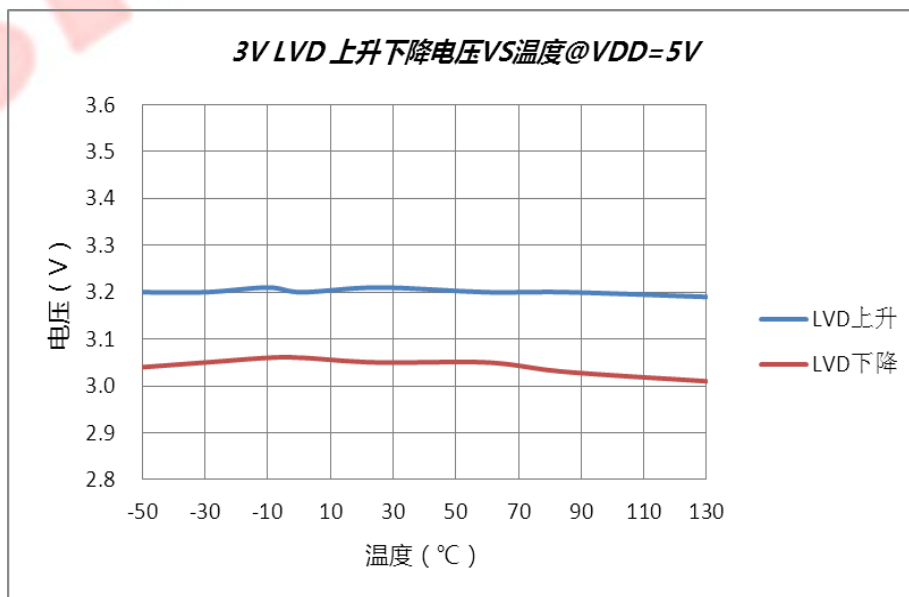
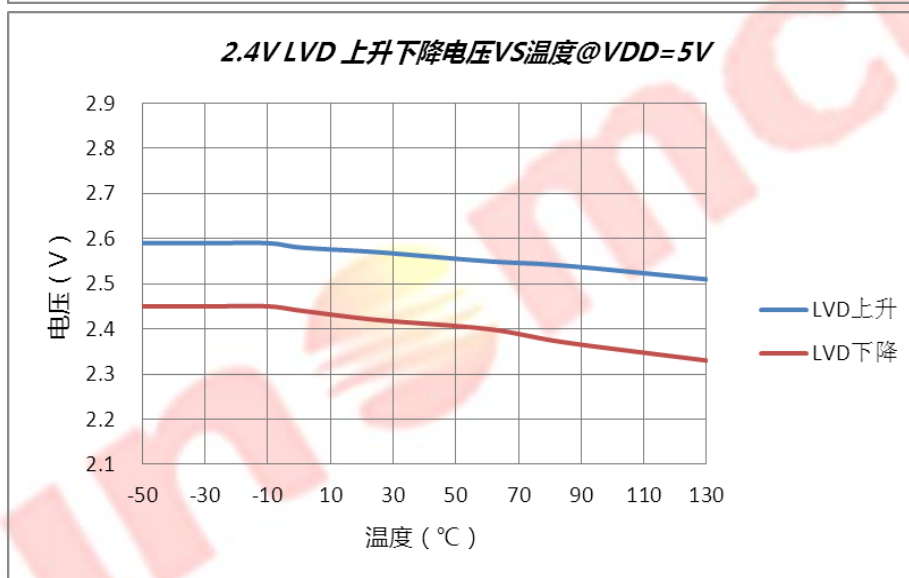
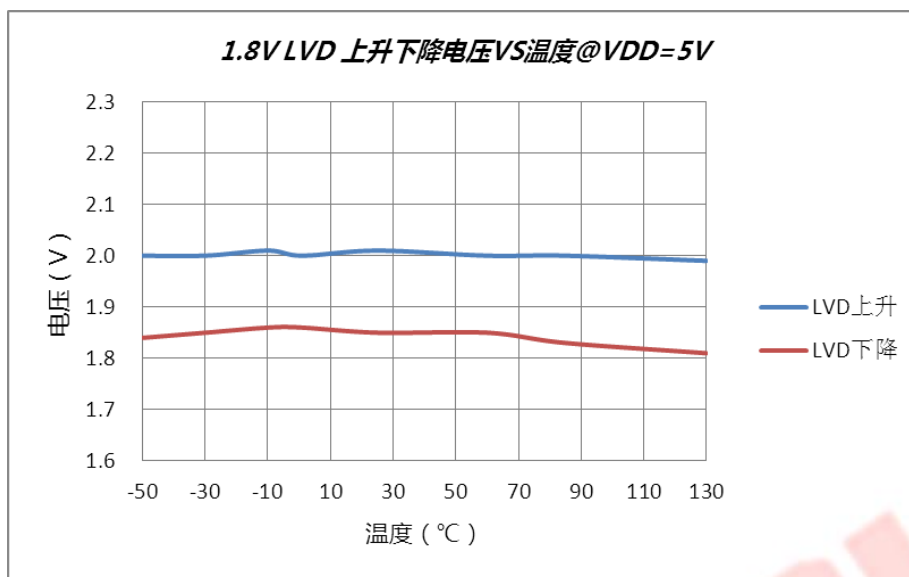


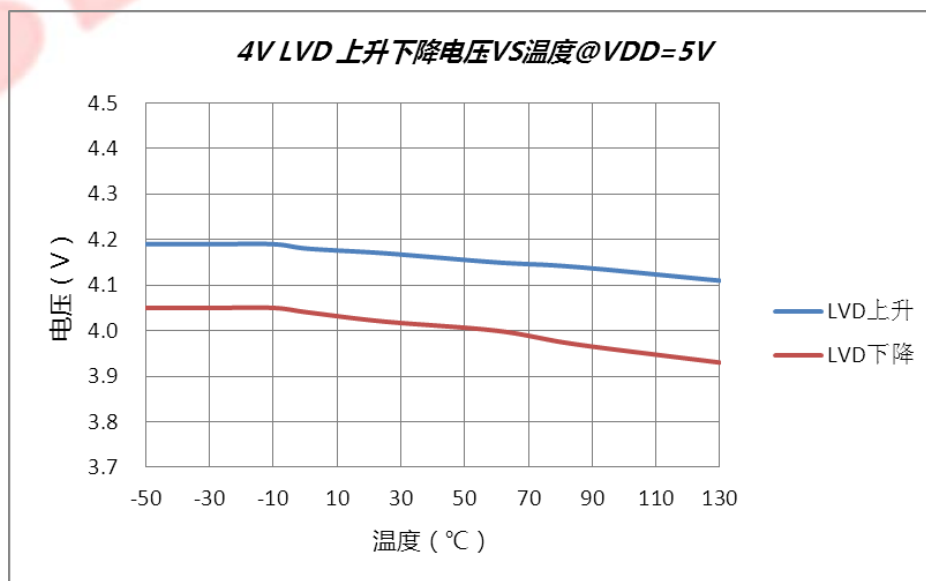
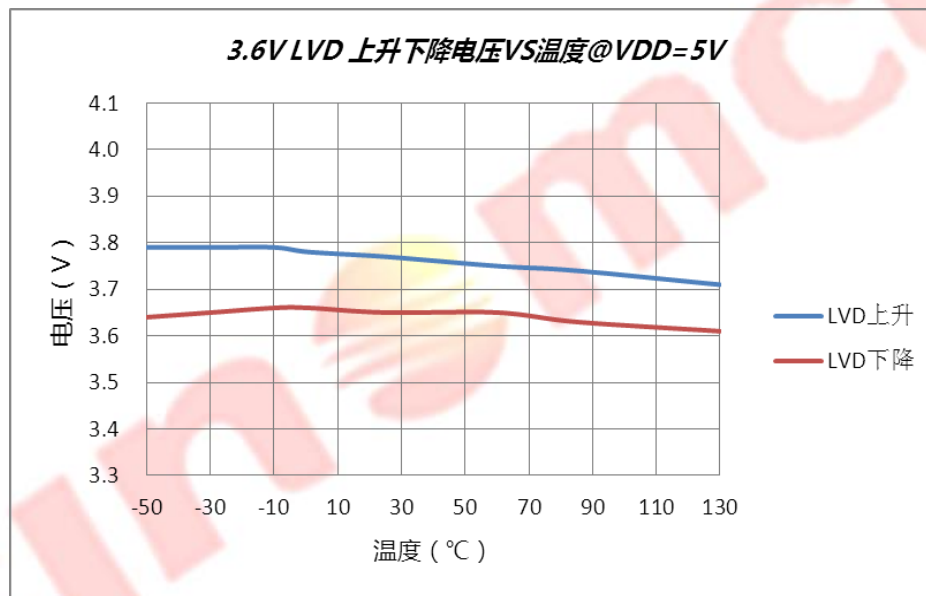
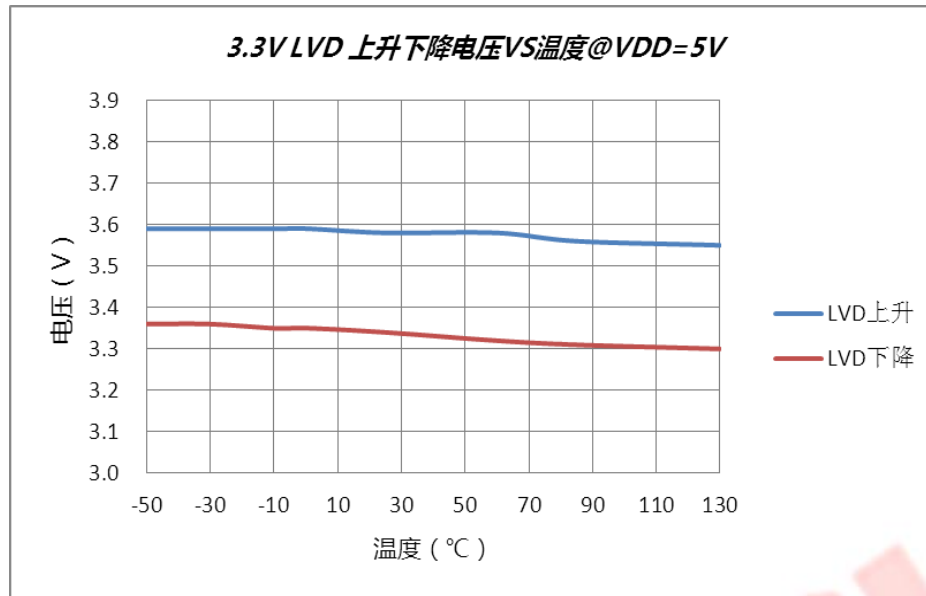
外部晶振起振/维持电压 VS 温度





LVD 电压 VS 温度

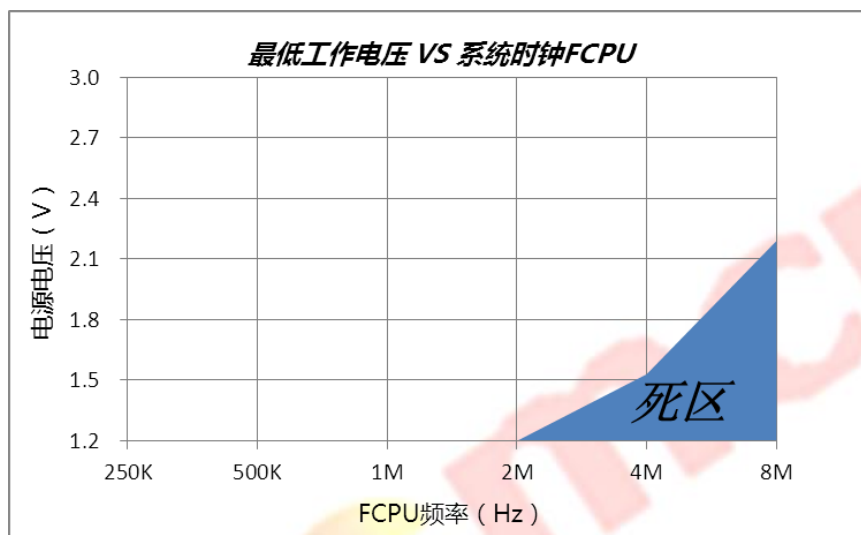




10.4 最低工作电压与系统时钟的关系

系统最低工作电压和系统工作频率 F_{CPU} 有关，不同的工作频率 F_{CPU} 最低工作电压不同。

如下图所示，当工作频率提高时系统正常工作电压也随之提高，但由于 POR 电压固定(1.2V@25°C)，在系统最低工作电压和 POR 电压之间就会出现一个不能正常工作的电压区域，此区域系统不能正常工作也不会产生 POR 复位，称之为死区，所以必须根据不同的工作频率设置大于死区电压的 LVR 电压，以避免出现死区。

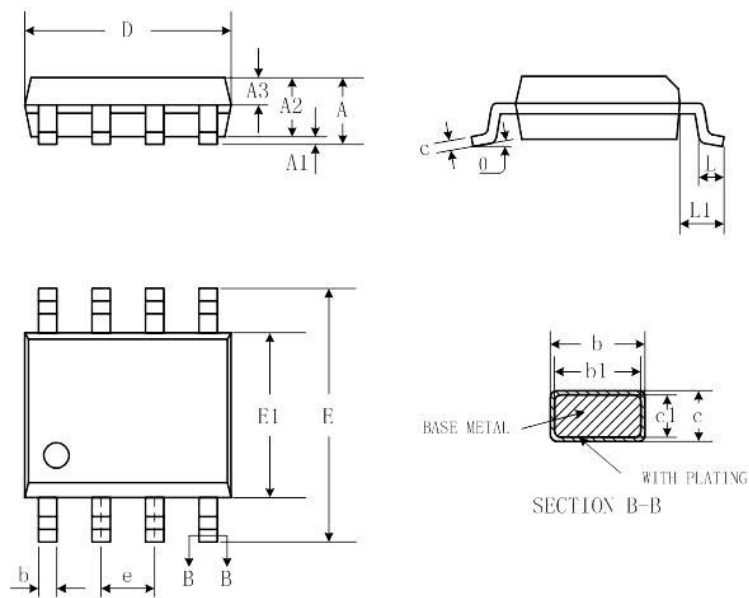


考虑到批量稳定性，建议 LVR 电压值高于死区电压 0.3V，故推荐 LVR 电压参照下表选择。如果使用外部晶体振荡器，LVR 电压值一定要高于晶体最低起振电压值。

F _{CPU} (Hz)	死区电压 (V)	推荐 LVR 电压值 (V)
8M	2.1	3.0
4M	1.6	2.7
2M	1.3	2.0
1M	1.3	2.0
500K	1.2	2.0
32768/2	1.2	1.8

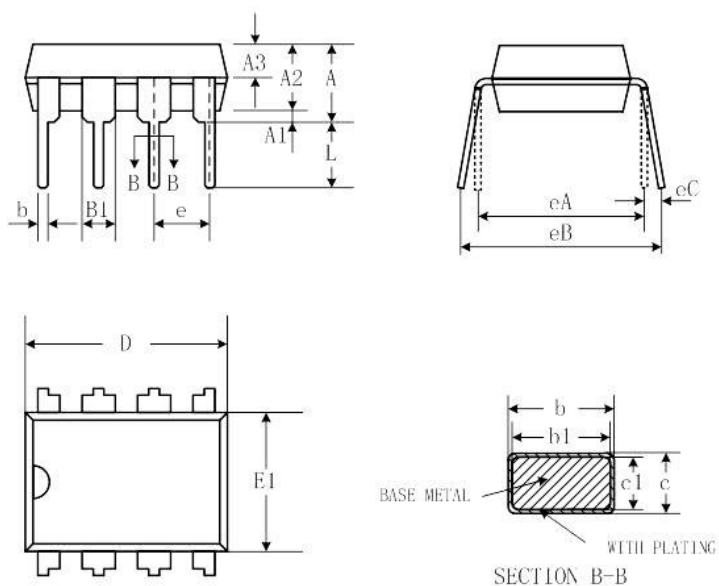
11 封装尺寸

11.1 SOP8



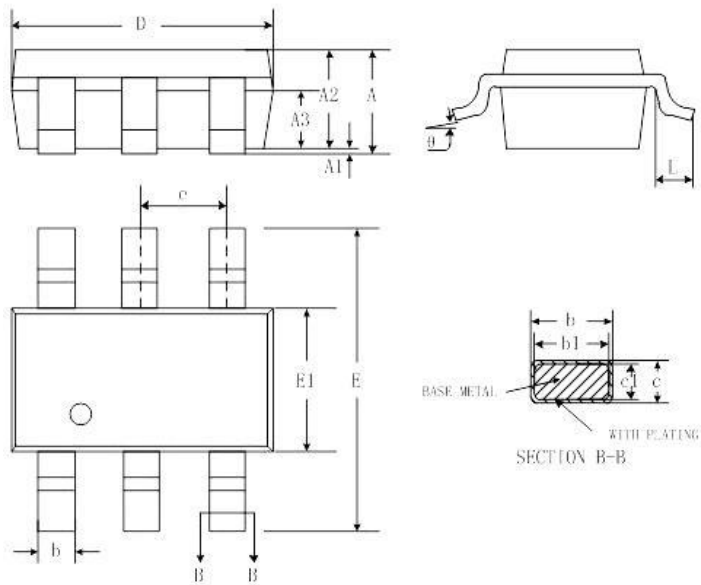
SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.77
A1	0.08	0.18	0.28
A2	1.20	1.40	1.60
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.39	-	0.48
b1	0.38	0.41	0.43
c	0.21	-	0.26
c1	0.19	0.20	0.21
D	4.70	4.90	5.10
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.70	3.90	4.10
e	1.27BSC		
L	0.50	0.65	0.80
L1	1.05BSC		
θ	0	-	8°

11.2 DIP8



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	TYP	MAX
A	3.60	3.80	4.00
A1	0.51	-	-
A2	3.10	3.30	3.50
A3	1.50	1.60	1.70
b	0.44	-	0.53
b1	0.43	0.46	0.48
B1	1.52BSC		
c	0.25	-	0.31
c1	0.24	0.25	0.26
D	9.05	9.25	9.45
E1	6.15	6.35	6.55
e	2.54BSC		
eA	7.62BSC		
eB	7.62	-	9.50
eC	0	-	0.94
L	3.00	-	-

11.3 SOT23-6



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.35
A1	0.04	-	0.15
A2	1.00	1.10	1.20
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.30	-	0.50
b1	0.30	0.40	0.45
c	0.08	-	0.22
c1	0.08	0.13	0.20
D	2.72	2.92	3.12
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.40	1.60	1.80
e	0.95BSC		
L	0.30	-	0.60
θ	0	-	8°

12 修订记录

版本	修订日期	修订内容
V1.0	2016-05-31	初版发布;
V1.1	2016-08-02	修改配置字 OSCM 定义;
V1.2	2016-09-09	修正直流参数拉电流项中端口的说明;
V1.3	2017-09-26	修改配置字 WDTT、LVRVS 定义; 修改工作电压参数和 HIRC 参数;
V1.4	2018-06-29	调整文档内容与排版; 去除配置字 ROTP/SPDS/FIL; 去除 HIRC 调频功能; 去除 POR 参数;
V1.5	2020-08-05	修改 LVRMD 和 WDTT 配置项说明; 修改或新增关于直流参数测试条件、开漏 I/O 输出高产生漏电流、低功耗模式未用引脚设置、复位时 VDD 上电慢的应对方法、LVD 开启/切换时的等待时间等相关的应用注释;